



无锡新洁能股份有限公司

(无锡市高浪东路999号B1号楼2层)



首次公开发行股票

招股说明书摘要

保荐机构（主承销商）



平安证券  
PING AN SECURITIES

平安证券股份有限公司

(深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层)

## 声 明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



## 第一节 重大事项提示

### 一、关于股份锁定的承诺

1、公司控股股东、实际控制人朱袁正及其一致行动人（叶鹏、戴锁庆、周洞濂、王成宏、顾朋朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆虹、肖东戈共计10人）承诺：

（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的首次公开发行股票前已发行的股份。

（2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。

（3）若本人直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于首次公开发行股票发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。

2、持有公司股份的达晨创投、上海贝岭、国联创投、金浦新投、金投控股、君熠投资、朱进强、中汇金玖、祥禾涌安、易辰创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠海横琴、郭艳芬、航虹智科、金控源悦、金控远东、顾成标、上海谙稷共计19名股东承诺：自公司本次发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理现已持有的公司股份，亦不由公司回购现已持有的股份。

3、持有公司股份的杨卓、朱兵、朱喜龙、宗臻、张照才、王根毅、周永珍、朱久桃、徐振彦、杲永亮、李春香、杨茜、季康康、刘晶晶、吕万雄、程月东、前海利信共计17名股东承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的首次公开发行股票前已发行的股份。

4、直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员朱袁正、叶鹏、王成宏、

顾朋朋、王永刚、陆虹、肖东戈承诺：

(1) 自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

(2) 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。

(3) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(4) 在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。

5、直接或间接持有公司股份的监事吴国强、李宗清承诺：

(1) 自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

(2) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(3) 在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本

人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。

## 二、关于减持意向及承诺

1、公司控股股东、实际控制人朱袁正及其一致行动人（叶鹏、戴锁庆、周洞濂、王成宏、顾朋朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆虹、肖东戈共计10人）承诺：

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

如本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于本次发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），每年减持数量不超过上一年末本人所持有公司股份的25%。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人拟减持公司股份时，将提前三个交易日通知公司并予以公告，未履行公告程序前不进行减持；本人减持公司股份将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。

2、其他持有公司5%以上股份的股东达晨创投、上海贝岭、国联创投和金浦新投承诺：

本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

## 三、稳定股价的承诺

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司特制订《无锡新洁能股份有限公司上市后三年内稳定股

价的预案》，主要内容如下：

#### “一、启动稳定股价措施的条件

上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”，审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），且非因不可抗力因素所致，则公司应按下述规则启动稳定股价措施。

#### 二、稳定股价的具体措施

##### （一）公司回购

1、公司为稳定股价之目的回购股票，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

2、公司董事会对回购股票作出决议，公司全体董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。

3、公司股东大会对回购股票做出决议，该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

4、公司为稳定股价进行股票回购时，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：

（1）公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），回购股份的方式为集中交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

（2）公司用于回购股票的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额，单次用于回购股票的资金不得低于人民币 500 万元。

(3) 公司单次回购股票不超过公司总股本的 2%。

## (二) 控股股东、实际控制人及其一致行动人增持

1、下列任一条件发生时，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

(1) 公司回购股票方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）。

(2) 公司回购股票方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动条件被再次触发。

2、控股股东、实际控制人及其一致行动人将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定股价，通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，控股股东、实际控制人及其一致行动人可不再实施上述买入公司股份计划。

3、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺单次增持金额不少于人民币 500 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。

4、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股票。

## (三) 董事、高级管理人员增持

1、下列任一条件发生时，公司董事（不包括独立董事、在公司任职但并不领取薪酬的董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

(1) 控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股票方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大



宗交易)均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理)。

(2)控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股票方案实施完毕之次日起的3个月内启动条件被再次触发。

2、有增持义务的公司董事、高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定股价,通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的,买入价格不高于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理)。但如果公司披露其买入计划后3个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件,可不再实施上述买入公司股份计划。

3、有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺,单次用以稳定股价的增持资金不少于其在公司担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的现金薪酬的20%,但不超过50%;单一会计年度用以稳定股价的增持资金合计不超过其在公司担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的现金薪酬的100%。有增持义务的董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

4、有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺,在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股票。

5、在公司董事、高级管理人员增持完成后,如果公司股票价格再次出现连续20个交易日每日股票加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),则公司应依照本预案的规定,依次开展公司回购、控股股东、实际控制人及其一致行动人增持及董事、高级管理人员增持工作。

6、公司若有新聘任董事(不包括独立董事、在公司任职但并不领取薪酬的董事)、高级管理人员,公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。

### 三、稳定股价措施的启动程序



### （一）公司回购

1、公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内做出回购股票的决议。

2、公司董事会应当在做出回购股票决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股票预案，并发布召开股东大会的通知。

3、公司应在股东大会做出决议之次日起开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕；

4、公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股票变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股票，办理工商变更登记手续。

### （二）控股股东、实际控制人及其一致行动人及董事、高级管理人员增持

1、公司董事会应在上述控股股东、实际控制人及其一致行动人及董事、高级管理人员增持条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告。

2、控股股东、实际控制人及其一致行动人及董事、高级管理人员应在增持公告做出之次日起开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。

## 四、稳定股价方案的终止情形

自股价稳定方案公告之日起 60 个工作日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

（一）公司股票连续 10 个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均高于公司最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）；

（二）继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件。

## 五、约束措施

在启动条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、有增持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、有增持义务的董事、高级管理人员承诺接受以下约

束措施：

（一）公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、有增持义务的董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（二）如果控股股东、实际控制人及其一致行动人未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与控股股东、实际控制人及其一致行动人拟增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

（三）如果有增持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与该等董事、高级管理人员拟增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

（四）如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，相关责任主体可免于前述约束措施，但其亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。

本预案需经公司股东大会审议通过，自公司完成首次公开发行 A 股股票并在主板上市之日起生效，有效期三年。”

公司承诺：在公司上市后三年内，若公司连续20个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司将按照《无锡新洁能股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股份。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：1、公司上市后三年内，若公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人将按照《无锡新洁能股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股票；2、本

人将根据公司股东大会批准的《无锡新洁能股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股票事宜召开的董事会与股东大会上，对回购股票的相关决议投赞成票。

公司全体董事承诺：1、本人将根据公司股东大会批准的《无锡新洁能股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会与股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票；2、本人将根据公司股东大会批准的《无锡新洁能股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

公司全体高级管理人员承诺：本人将根据公司股东大会批准的《无锡新洁能股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

## 四、关于信息披露违规的承诺

### 1、发行人承诺

公司承诺：本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在中国证监会就此对公司作出行政处罚决定生效之日起三十日内，公司召开股东大会审议回购首次公开发行的全部新股的方案，并在股东大会审议通过之日起五日内启动回购方案，回购价格以公司首次公开发行价格加上同期银行存款利息和二级市场价格孰高者确定（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

## 2、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

朱袁正及其一致行动人承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在公司股东大会审议通过回购首次公开发行的全部新股的方案之日起五日内，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股并将启动回购方案，并购回首次公开发行股票时本公司公开发售的股票（如有），购回价格以公司首次公开发行价格加上同期银行存款利息和二级市场价格孰高者确定（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

## 3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺

若本招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

## 4、中介机构相关承诺

保荐机构平安证券股份有限公司承诺：因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

发行人律师江苏世纪同仁律师事务所承诺：因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

申报会计师、验资机构及验资复核机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

## 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件之要求，公司召开股东大会审议通过了公司本次融资填补即期回报措施及相关承诺等事项。

公司拟通过多种措施提升公司的盈利能力，积极应对外部环境变化，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，具体措施请仔细阅读招股说明书“第十一节 管理层分析与讨论”之“九、本次募集资金到位当年即期回报摊薄情况以及填补被摊薄即期回报措施与相关承诺”相关内容。

为了保障公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送，也不采用其他方式损害公司利益。（2）对自身的职务消费行为进行约束。（3）不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动。（4）将尽职促使公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。（5）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺将尽职促使公司未来拟公布的股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。（6）本承诺出具日后，若监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构相关规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。（7）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，然而由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

## 六、发行前滚存未分配利润的安排及本次发行上市后的股利分配政策

### （一）发行前滚存未分配利润的安排

根据公司通过的2018年第三次临时股东大会决议：为兼顾新老股东利益，在公司首次公开发行股票完成后，由本公司新老股东按持股比例共同享有本次首次公开发行股票前的滚存利润。

### （二）本次发行上市后的股利分配政策

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程(草案)》，公司发行上市后的利润分配政策如下：

#### “（一）公司利润分配原则

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

#### （二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

#### （三）现金分红条件

公司实施现金分红一般应同时满足以下条件：

1、公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以

满足公司正常生产经营的需要；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）。

3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的 50%且超过 5000 万元人民币。

#### （四）现金分红的比例和间隔：

公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的 50%且超过 5000 万元人民币。

#### （五）发放股票股利的条件

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

#### （六）利润分配的决策机制和程序

1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

#### （七）利润分配政策调整的决策机制与程序

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并分别经监事会和二分之一以上独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体董事的二分之一以上同意。”

此外，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了公司董事会制定的《关于



公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。

关于股利分配的详细政策，请仔细阅读招股说明书“第十四节 股利分配政策”关于股利分配的相关内容。

## 七、公司特别提醒投资者注意招股说明书“第四节 风险因素”中的下列风险

### 1、市场波动风险

半导体分立器件作为基础性电子元器件，为国民经济的多个领域所必不可少，因此半导体分立器件行业的下游分布极为广泛。广泛的下游应用领域提升了公司应对单一市场波动风险的能力，但半导体分立器件行业与宏观经济的整体发展的景气程度密切相关，国内经济整体增速放缓及中美贸易摩擦等因素通过对下游行业的生产经营产生不利影响进而传导至半导体分立器件行业。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，半导体分立器件行业的市场需求也将随之受到影响；下游行业的波动和低迷会导致对半导体分立器件的需求下降、价格敏感性提高。虽然近几年全球半导体分立器件市场保持稳步增长，且亚洲地区特别是中国市场规模增幅巨大，但是如果由于中美贸易摩擦等因素引致下游市场整体持续波动、全球经济或国内经济发生重大不利变化，将对半导体分立器件行业及公司等行业内企业的经营业绩造成不利影响。

### 2、供应商依赖的风险

公司是半导体专业化垂直分工企业，芯片代工及封装测试环节主要通过向供应商采购。公司拥有涵盖了华虹宏力、华润上华、中芯集成等国内少数几家具备MOSFET、IGBT等8英寸半导体芯片代工能力的本土芯片代工供应商，并不断拓展韩国等地区的芯片代工供应渠道。而在封装测试环节，公司主要与长电科技（600584）、安靠技术（Amkor）、通富微电（002156）等全球领先的封装测试企业合作，一定程度上也保证了公司产品的领先性。由于半导体行业垂直分工的特殊性，专注于芯片设计环节的企业在选择供应商后一般不会轻易更换；同样，芯片代工及封装测试企业如若更换客户则需重新调整产线、设备技术参数、产能排期等，这将形成较大的更换成本。因此，双方在一定程度上相互依赖。如果公司

主要供应商产能严重紧张或者双方关系恶化，则可能导致公司产品无法及时、足量供应，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

### 3、供应链管理不善风险

半导体分立器件行业高度分工协作，产业链包括芯片设计、芯片制造、封装测试、对外销售等环节，各个环节相互依存、高度相关。行业内企业根据分工不同采用垂直一体化或垂直分工模式，其中部分垂直分工模式的企业主要负责芯片设计研发和销售环节，而将芯片制造、封装测试环节主要委托给专业代工厂商完成，因此，其产品质量、交货时间、生产能力等都与产业链其他环节紧密相关。公司为专业化垂直分工企业，与行业内优秀的芯片制造和封装测试厂商建立了长期、稳定的合作关系。公司建成封装测试产线，实现少部分功率器件的自主生产，公司不断加强生产环节的质量、成本管控，保障产品的品质。但是，如果公司对供应链及生产环节管理不善，导致产品质量、交付及时性等问题出现，则会影响公司产品销售和品牌声誉，对公司的经营造成不利影响。

### 4、毛利率下降的风险

2017年至2019年，公司综合毛利率分别为24.69%、31.63%和20.73%。2017年至2018年，受益于下游市场需求的持续增长，积极拓展毛利率较高的下游应用行业，大力开发新产品和新技术，积极开拓龙头客户从而提升公司品牌影响力和市场美誉度，公司综合毛利率保持稳定上升的趋势。2019年，受中美贸易摩擦及国内市场竞争有所加剧等因素影响，公司芯片和功率器件毛利率有所下降。半导体分立器件企业的经营业绩受产品技术水平、市场竞争情况、下游市场需求等因素影响较大，如果未来公司产品技术优势减弱、市场竞争加剧、市场供求形势出现重大不利变化、采购成本持续提高或者出现产品销售价格持续下降等情况，将导致公司综合毛利率下降。

## 八、财务报告审计截止日至招股说明书签署日主要财务信息及经营情况

### 1、2020年1-6月经营情况

公司财务报告审计截止日为2019年12月31日，天衡会计师事务所（特殊普

通合伙) 对公司截止 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表, 2020 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅, 并出具了天衡专字(2020)01542 号《审阅报告》。

发行人 2020 年 1-6 月财务报表主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动比率
总资产	79,265.73	80,785.53	-1.88%
股东权益	62,695.81	57,161.92	9.68%
其中: 归属于母公司股东权益	62,695.81	57,161.92	9.68%
项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	变动比率
营业收入	38,428.31	32,834.82	17.04%
营业利润	6,227.02	4,227.91	47.28%
利润总额	6,228.03	4,231.56	47.18%
净利润	5,533.89	3,743.16	47.84%
归属于母公司股东的净利润	5,533.89	3,743.16	47.84%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5,312.28	3,510.35	51.33%
经营活动产生的现金流量净额	-2,042.33	2,730.55	-174.80%

## 2、2020 年 1-9 月业绩预计

公司结合 2020 年 1-6 月经营及财务数据, 预计 2020 年 1-9 月营业收入区间为 64,000.00 万元至 65,500.00 万元, 同比上涨 18.05%至 20.82%; 预计 2020 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润区间为 9,200.00 万元至 9,700.00 万元, 同比上涨 44.82%至 52.69%; 预计 2020 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为 8,800.00 万元至 9,300.00 万元, 较上年同期上涨 49.29%至 57.77%。

上述业绩预计的相关财务数据是发行人初步测算结果, 预计数不代表发行人最终可实现的营业收入及净利润, 也不代表发行人所做的盈利预测。

财务报告审计截止日至本招股说明书签署日, 公司的经营模式、主要生产产品的生产、销售, 主要客户及供应商的构成, 税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大不利变化。

## 第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	本次公开发行股票2,530万股，不低于发行后总股本的25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
每股发行价格	19.91元
市盈率	22.99倍（发行价格除以每股收益，每股收益按2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	7.53元/股（以2019年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	10.09元/股（以2019年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
市净率	1.97倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合相关资格规定的询价对象和在上海证券交易所开立股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（中华人民共和国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	<p>1、控股股东、实际控制人朱袁正及其一致行动人（叶鹏、戴锁庆、周洞濂、王成宏、顾朋朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆虹、肖东戈共计10人）承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的首次公开发行股票前已发行的股份。（2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。（3）若本人直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于首次公开发行股票发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。</p> <p>2、持有公司股份的达晨创投、上海贝岭、国联创投、金浦新投、金投控股、君熠投资、朱进强、中汇金玖、祥禾涌安、易辰创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠海横琴、郭艳芬、航虹智科、金控源悦、金控远东、顾成标、上海谙稷共计19名股东承诺：自公司本次发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理现已持有的公司股份，亦不由公司回购现已持有的股份。</p> <p>3、持有公司股份的杨卓、朱兵、朱喜龙、宗臻、张照才、王根毅、</p>

	<p>周永珍、朱久桃、徐振彦、杲永亮、李春香、杨茜、季康康、刘晶晶、吕万雄、程月东、前海利信共计17名股东承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>4、持有公司股份的董事、高级管理人员朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋、王永刚、陆虹、肖东戈承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。（2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。（3）除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。（4）在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。</p> <p>5、持有公司股份的监事吴国强、李宗清承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。（2）除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。（3）在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	本次发行预计募集资金 50,372.30 万元
预计募集资金净额	扣除发行费用后，本次发行预计募集资金净额 44,898.80 万元
发行费用概算	<p>本次发行费用预计共需 5,473.50 万元，其中：</p> <p>承销费用与保荐费用：3,800.00 万元</p> <p>审计费用与验资费用：631.13 万元</p> <p>律师费用：545.28 万元</p>



	用于本次发行的信息披露费用：452.83 万元 发行手续费：44.26 万元 (注：以上发行费用均为不含税金额)
拟上市地点	上海证券交易所



## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本资料

注册中文名称	无锡新洁能股份有限公司
注册英文名称	WUXI NCE POWER CO.,LTD.
注册资本	7,590.00 万元
法定代表人	朱袁正
成立日期	2013 年 1 月 5 日
住所及其邮政编码	无锡市高浪东路 999 号 B1 号楼 2 层 (214000)
电话号码	0510-85618058
传真	0510-85620175
互联网网址	<a href="http://www.ncepower.com">http://www.ncepower.com</a>
电子信箱	Info@ncepower.com

### 二、发行人历史沿革及设立情况

#### (一) 设立方式

新洁能系经江苏省无锡工商行政管理局出具的《江苏省无锡工商行政管理局准予设立登记通知书》((02000047) 公司设立[2013]第 01040001 号) 批准, 由朱袁正、新潮集团、新洁能半导体共同发起设立的股份有限公司。公司于 2013 年 1 月 5 日取得江苏省无锡工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号: 320200000204840), 注册资本 1,000.00 万元。

#### (二) 发起人及其投入的资产内容

发行人系由朱袁正、新潮集团和新洁能半导体以货币出资方式共同发起设立, 设立时的主要资产为各股东缴付出资的货币资金。

### 三、发行人的股本情况

#### (一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排



本次发行前公司总股本为 7,590.00 万股，本次公开发行 2,530.00 万股，发行后总股本为 10,120.00 万股。按本次发行新股 2,530.00 万股计算，发行前后公司的股本结构变化如下：

股东名称	发行前		发行后	
	股份数量（万股）	比例	股份数量（万股）	比例
<b>一、有限售条件股份</b>				
朱袁正	2,361.60	31.11%	2,361.60	23.34%
达晨创投	660.00	8.70%	660.00	6.52%
上海贝岭	600.00	7.91%	600.00	5.93%
国联创投	420.00	5.53%	420.00	4.15%
金浦新投	402.00	5.30%	402.00	3.97%
金投控股	334.20	4.40%	334.20	3.30%
君熠投资	334.20	4.40%	334.20	3.30%
朱进强	300.00	3.95%	300.00	2.96%
中汇金玖	270.00	3.56%	270.00	2.67%
祥禾涌安	240.00	3.16%	240.00	2.37%
易辰创投	228.00	3.00%	228.00	2.25%
君昕投资	199.80	2.63%	199.80	1.97%
武岳峰浦江	165.00	2.17%	165.00	1.63%
珠海横琴	150.00	1.98%	150.00	1.48%
叶 鹏	123.00	1.62%	123.00	1.22%
郭艳芬	90.00	1.19%	90.00	0.89%
航虹智科	90.00	1.19%	90.00	0.89%
金控源悦	90.00	1.19%	90.00	0.89%
金控远东	75.00	0.99%	75.00	0.74%
前海利信	60.00	0.79%	60.00	0.59%
戴锁庆	60.00	0.79%	60.00	0.59%
顾成标	60.00	0.79%	60.00	0.59%
王成宏	48.00	0.63%	48.00	0.47%
周洞濂	30.00	0.40%	30.00	0.30%
顾朋朋	24.00	0.32%	24.00	0.24%
肖东戈	15.00	0.20%	15.00	0.15%
杨 卓	12.00	0.16%	12.00	0.12%





朱 兵	12.00	0.16%	12.00	0.12%
朱喜龙	12.00	0.16%	12.00	0.12%
宗 臻	12.00	0.16%	12.00	0.12%
李宗清	12.00	0.16%	12.00	0.12%
吴国强	12.00	0.16%	12.00	0.12%
上海谙稷	10.20	0.13%	10.20	0.10%
陆 虹	9.00	0.12%	9.00	0.09%
张照才	9.00	0.12%	9.00	0.09%
王永刚	9.00	0.12%	9.00	0.09%
王根毅	9.00	0.12%	9.00	0.09%
周永珍	9.00	0.12%	9.00	0.09%
朱久桃	9.00	0.12%	9.00	0.09%
徐振彦	6.00	0.08%	6.00	0.06%
杨 茜	4.00	0.05%	4.00	0.05%
李春香	3.50	0.05%	3.50	0.05%
杲永亮	3.00	0.04%	3.00	0.03%
季康康	3.00	0.04%	3.00	0.03%
刘晶晶	3.00	0.04%	3.00	0.03%
吕万雄	0.75	0.01%	0.75	0.01%
程月东	0.75	0.01%	0.75	0.01%
<b>二、本次发行股份</b>				
社会公众股东	-	-	2,530.00	25.00%
<b>合 计</b>	<b>7,590.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,120.00</b>	<b>100.00%</b>

1、公司控股股东、实际控制人朱袁正及其一致行动人（叶鹏、戴锁庆、周洞濂、王成宏、顾朋朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆虹、肖东戈共计10人）承诺：

（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的首次公开发行股票前已发行的股份。

（2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除

息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。

(3) 若本人直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于首次公开发行股票发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。

2、持有公司股份的达晨创投、上海贝岭、国联创投、金浦新投、金投控股、君熠投资、朱进强、中汇金玖、祥禾涌安、易辰创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠海横琴、郭艳芬、航虹智科、金控源悦、金控远东、顾成标、上海谙稷共计19名股东承诺：自公司本次发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理现已持有的公司股份，亦不由公司回购现已持有的股份。

3、持有公司股份的杨卓、朱兵、朱喜龙、宗臻、张照才、王根毅、周永珍、朱久桃、徐振彦、杲永亮、李春香、杨茜、季康康、刘晶晶、吕万雄、程月东、前海利信共计17名股东承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的首次公开发行股票前已发行的股份。

4、持有公司股份的董事、高级管理人员朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋、王永刚、陆虹、肖东戈承诺：

(1) 自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

(2) 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。

(3) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(4) 在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不

转让本人直接或间接持有的公司股份；不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。

#### 5、持有公司股份的监事吴国强、李宗清承诺：

(1) 自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

(2) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(3) 在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。

## (二) 发起人持股数量及比例

公司设立时总股本为 1,000.00 万股，发起人为朱袁正、新潮集团和新洁能半导体。公司发起设立时，各发起人的持股数量及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	股权比例
1	朱袁正	510.00	51.00%
2	新潮集团	470.00	47.00%
3	新洁能半导体	20.00	2.00%
合计		1,000.00	100.00%

## (三) 发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

截至招股说明书签署日，公司发起人、控股股东、持股 5% 以上的主要股东

之间的关联关系如下：

主要股东/发起人名称	关联关系
朱袁正	公司实际控制人、控股股东朱袁正原参股的其他企业
新洁能半导体	

除上述关联关系外，发起人、控股股东、持股 5% 以上的主要股东之间不存在关联关系。

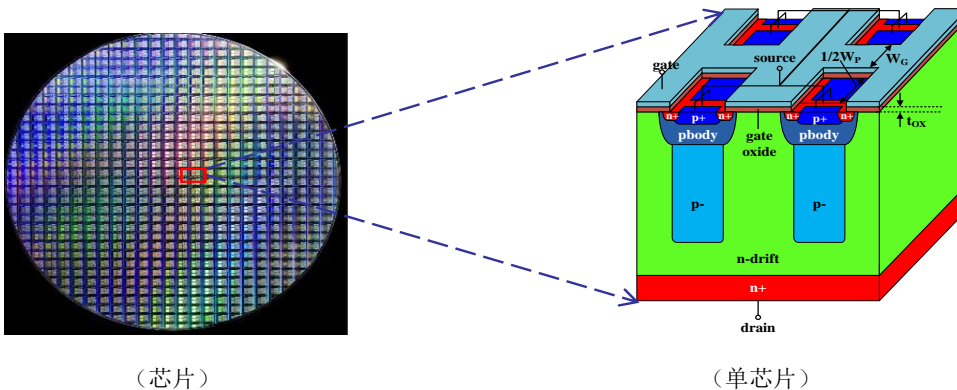
## 四、发行人的业务情况

### （一）发行人的主营业务及产品

公司的主营业务为 MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售，公司销售的产品按照是否封装可以分为芯片和功率器件。公司产品系列齐全，广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子、新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等领域。

公司主要产品按形态分类具体情况如下：

#### ① 芯片

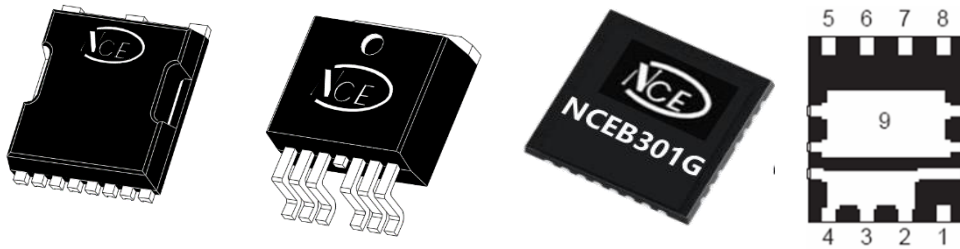


注：“芯片”中包含数千颗“单芯片”产品；“单芯片”用于封装功率器件的单芯片

公司是半导体行业内专业化垂直分工企业。芯片是由公司通过复杂的技术研发和产品设计流程后，将包含核心技术文档在内的研发设计方案交由芯片代工企业，芯片代工企业再通过其光刻、刻蚀、离子注入和正面金属化等半导体工艺制造流程，将晶圆材料片等原材料加工成包括电路结构、器件特定功能在内的芯片产品。下游部分客户采购公司芯片产品后，可以通过与其他种类的芯片和电子元

器件合封，组合后形成具备特定功能的器件，再安装在电路板中实现相关作用。每片 8 英寸芯片包含数百颗至数万颗数量不等的单芯片，单芯片可以通过进一步封装测试形成半导体封装成品，即功率器件。

## ②功率器件

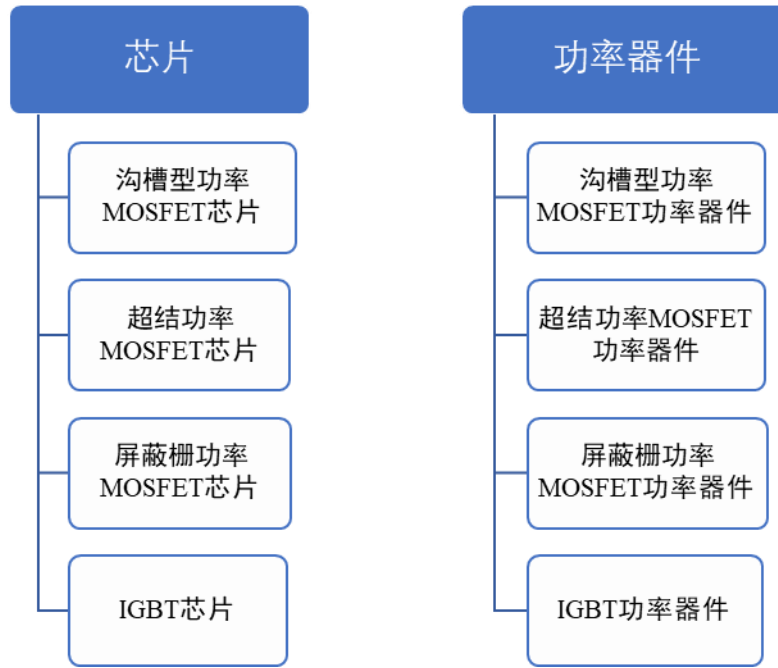


注：上述功率器件的封装外形依次为：TOLL 封装、TO-263-7L 封装、DFN5×6 封装和 DFN5×6 双基岛封装

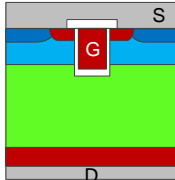
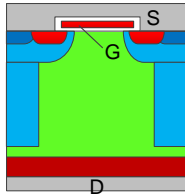
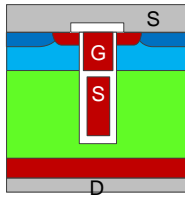
功率器件主要由公司委托外部封装测试企业对芯片进行封装测试而成，少部分由公司自主封装后销售。功率器件主要是指已经封装好的 MOSFET、IGBT 等封装成品，主要结构包括芯片、塑封外壳、金属底座以及引线等结构，其中芯片是核心，发挥主要功能作用。芯片通过焊料固定在框架上、连同塑封外壳等给芯片提供支撑、保护、散热以及电气连接和隔离等作用，以便使器件与其他无源器件和有源器件等构成完整的电路系统。公司功率器件系列齐全，下游应用领域广泛，收入占比逐年增长。

公司产品器件结构不同、功能有所差异，主要分类包括沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)以及功率模块等多品类产品系列。

综上，公司的主要产品类型如下所示：



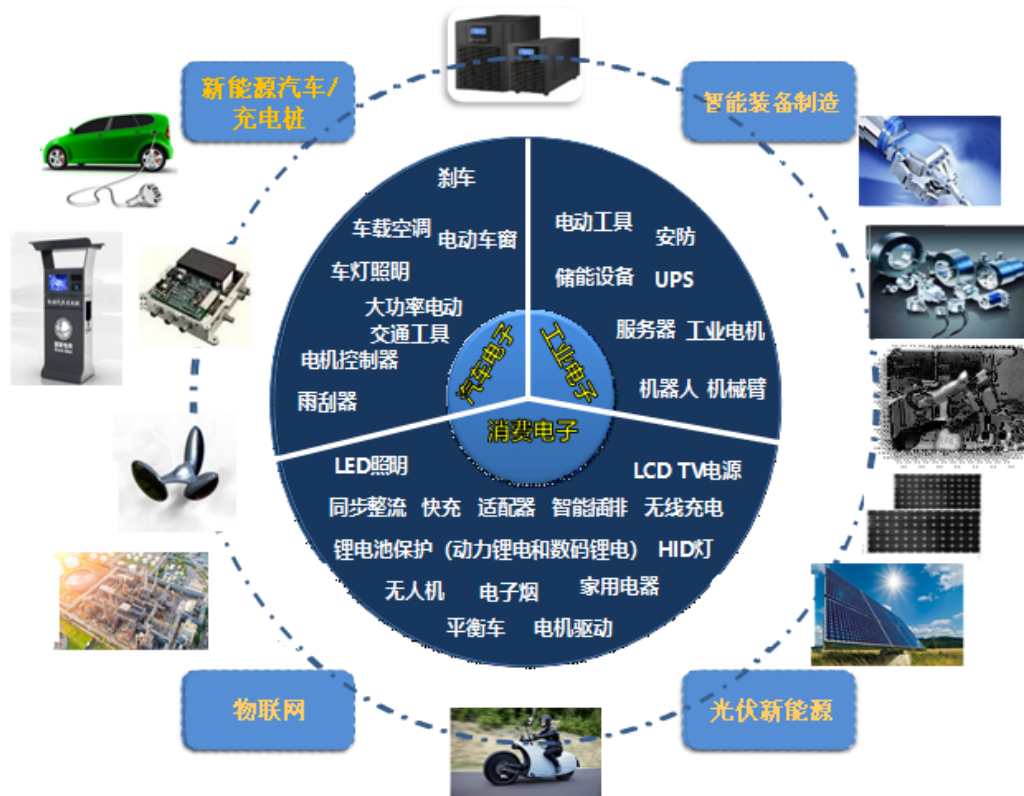
公司各类产品使用先进的设计技术和制造工艺来实现半导体功率器件低导通损耗、低开关损耗和高可靠性，从而提升能源转换效率，能满足不同的客户应用需求。公司各类产品的示意图及适用领域如下：

类别	具体内容	产品芯片元胞及部分产品示意图	适用领域
沟槽型功率 MOSFET	12V-250V 沟槽型功率 MOSFET		MID、移动电源、手机数据线、数码类锂电池保护板、车载导航、汽车应急启动电源、多口 USB 充电器、LED 户外广告屏、电动车控制、逆变器、适配器、充电器、LED 电源、HID 灯、手机快充、金牌 PC 电源、TV 电源板、电脑显卡、UPS 电源等。
超结功率 MOSFET	500V-900V 超结功率 MOSFET		手机充电器、快充、LED 驱动电源、适配器、大功率电动车充电器、大功率 LED 调光电源、超薄类 PC 适配器、TV 电源板、电动汽车充电桩、通信电源等。
屏蔽栅功率 MOSFET	30V-300V 屏蔽栅功率 MOSFET		电子雾化器、充电桩、电动工具、智能机器人、无人机、移动电源、数码类锂电池保护板、多口 USB 充电器、电动车控制、逆变器、适配器、手机快充、金牌 PC 电源、TV 电源板、UPS 电源等。

IGBT	高密度场截止型绝缘栅双极型晶体管(IGBT)		UPS 电源、电焊机、电动汽车充电桩、变频器、逆变器、功率电源、太阳能、交流电机驱动、电磁加热等。
	载流子存储型绝缘栅双极型晶体管(IGBT)		
其他	MOSFET 或 IGBT 功率模块	 (实物图)	大功率电动三轮车、电动四轮车、低速电动汽车、高速电动汽车的电机控制，大功率马达驱动等。

公司的产品用途广泛，主要运用于消费电子、汽车电子、工业电子以及新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等新兴领域。

公司产品下游运用行业情况如下图所示：



公司不断对产品系列更新升级，积极延伸所处产业链，逐步进入半导体功率器件的封装测试领域。目前，公司已初步建成先进封装测试生产线，实现少部分功率器件的自主生产。从产业链的角度来看，公司掌握了芯片设计、封装测试等重要环节，能依据行业技术发展和市场需求变动开展研发设计、并依据终端客户的需求直接生产所需产品，有利保证产品质量、提升产品性能、促进新产品开发、保障产品供应及获取更多的产业链价值。

## （二）产品销售模式

公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。在直销模式下，客户给公司下达订单，公司将产品交付给客户；公司经销模式为买断式经销，在该模式下公司将产品送至经销商。公司建立了完善的客户管理制度，对于长期合作客户，公司与其签订框架合作协议，并安排专员提供全方位服务；对于其他客户，公司根据客户的订单给其供货。公司仓管部负责产品发运，销售处负责产品售后服务。半导体行业上下游之间粘性较强，公司产品需要通过较为严格的质量认证测试，一旦受到客户的认可和规模化使用后，双方将形成长期稳定的合作关系。

## （三）主要采购内容供应情况

### 1、采购内容

报告期内，公司销售的产品按照是否封装可以分为芯片和功率器件。公司是专业化垂直分厂商，芯片主要由公司设计方案后交由芯片代工企业进行生产，功率器件主要由公司委托外部封装测试企业对芯片进行封装测试而成。因此，公司主要对外采购芯片代工及封测服务。

### 2、能源

公司能源消耗主要为办公用水、电等，该等能源供应稳定且整体金额较小。

## （四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

中国产业信息网发布的《2014-2019 年中国半导体器件市场分析预测及投资战略咨询报告》显示，我国半导体分立器件行业集中度低，规模以上的半导体分立器件企业约有 2,000 家。行业内少数优质企业通过长期的技术积累和持续的自



主创新，能够设计或生产附加值较高的产品，并满足客户严苛的产品认证标准，市场知名度较高，在国内竞争主体众多的环境中处于领先地位。

公司为国内领先的半导体功率器件设计企业之一，是国内 8 英寸先进工艺平台芯片投片量最大的半导体功率器件设计公司之一，也是国内半导体功率器件行业内最早专门从事 MOSFET、IGBT 研发设计的企业之一。在中国半导体行业协会发布的 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年中国半导体功率器件企业排行榜中，公司连续四年名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司是江苏省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合认定的高新技术企业，且为中国半导体行业协会会员、中国电源学会理事单位。公司亦为江苏半导体行业协会 2017 年度先进会员单位，已建立了江苏省功率器件工程技术研究中心、江苏省企业研究生工作站、东南大学-无锡新洁能功率器件技术联合研发中心。

自成立以来，公司始终专注于半导体功率器件行业，具备独立的 MOSFET 和 IGBT 芯片设计能力和自主的工艺流程设计平台。公司基于全球半导体功率器件先进理论技术开发领先产品，是国内率先掌握超结理论技术，并量产屏蔽栅功率 MOSFET 及超结功率 MOSFET 的企业之一，是国内最早同时拥有沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET 及 IGBT 四大产品平台的本土企业之一。公司新产品开发能力强，产品导入市场速度快，已经掌握屏蔽栅功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、IGBT 等特色工艺技术，并形成了具有自主知识产权的核心技术体系。公司产品数量众多，应用广泛，特别能满足如消费电子、汽车电子、工业电子以及新兴领域的终端客户对产品的技术参数和性能多样性的需求，具有一定的市场占有率和较强的品牌影响力。

公司未来将以当前在市场中的竞争能力以及核心竞争优势为基础，巩固现有的市场地位，在国家产业政策大力支持下，继续开拓市场，加大研发力度，实现持续快速发展。

根据全球知名市场研究机构 IHS 统计数据显示，2016 年、2017 年国内 MOSFET 市场份额分别为 22.07 亿美元、26.39 亿美元。公司 2016 年、2017 年分别占国内 MOSFET 市场份额比例分别为（年度平均汇率分别为 6.6423、6.7518）2.88%、2.83%，且公司为除英飞凌（Infineon）、安森美（ON Semiconductor）、瑞

萨电子 (Renesas Electronics) 等 9 家外资品牌外的国内排名前茅的 MOSFET 研发设计及销售本土企业。根据 IHS、电子工程世界网 Yole 相关数据, 2018 年全球 MOSFET 市场份额预计将增长至 76 亿美元, 比照 Yole 关于国内功率器件占全球份额约 39% 测算, 国内 2018 年 MOSFET 市场份额预计将达到 29.64 亿美元, 公司占国内 MOSFET 市场份额比例达 3.65%。

在中国半导体行业协会发布的中国半导体功率器件企业排行榜中, 公司均名列其中, 具体排名如下:

序号	荣誉名称	名次	颁发单位
1	2019 年中国半导体行业功率器件十强企业	7	中国半导体行业协会 (CSIA)
2	2018 年中国半导体行业功率器件十强企业	6	
3	2017 年中国半导体行业功率器件十强企业	7	
4	2016 年中国半导体行业功率器件十强企业	9	

二极管、三极管、晶闸管等半导体功率器件主要基于投资规模为十亿元以内的 4、6 英寸晶圆片工艺平台进行生产, 国内以上述产品为主的部分上市公司具备资本实力可以自建产线进行生产, 因此主要采取 IDM 模式; 而 MOSFET、IGBT 等因其产品特性和较高工艺要求则主要基于投资规模约 30 亿元的 8 英寸晶圆片工艺平台进行生产, 行业内企业一般主要从事产品的研发设计, 而将芯片制造委托给纯代工企业进行生产。在中国半导体行业功率器件十强企业中, 公司为唯一一家主要基于先进的 8 英寸晶圆片工艺平台、且专门从事 MOSFET 和 IGBT 等半导体功率器件研发设计、并主要采用 Fabless 模式的非上市企业。

2018 年中国半导体行业功率器件十强企业主要情况如下表所示:

排名	企业名称	经营规模	业务模式	产品结构
1	扬杰科技 (300373)	上市公司。 2017 年度营业收入为 14.70 亿元; 2018 年度营业收入为 18.52 亿元; 2019 年度营业收入为 20.07 亿元;	IDM 模式	专业从事二极管系列产品, 包括快恢复二极管、齐纳二极管、整流桥等, 目前正逐步开发自己的 MOSFET 产品。
2	华微电子	上市公司。	IDM 模式	其产品主要为功率半导

	(600360)	2017 年度营业收入为 16.35 亿元; 2018 年度营业收入为 17.09 亿元; 2019 年度营业收入为 16.56 亿元;		体, 主要包括二极管、三极管、双极型功率晶体管、MOSFET 和 IGBT。
3	无锡华润华晶微电子有限公司	央企下属企业(非上市公司)	IDM 模式	主要产品为双极型功率晶体管、MOS 型功率晶体管、IGBT 和特种二极管等
4	苏州固锟(603501)	上市公司。 2017 年度营业收入为 18.5 亿元; 2018 年度营业收入为 18.9 亿元; 2019 年度营业收入 19.81 亿元;	IDM 模式	半导体整流器件芯片、功率二极管、整流桥等产品
5	乐山无线电股份有限公司	民营企业(非上市公司)	IDM 模式	主要产品包含二极管、三极管、集成电路、桥式整流器、MOSFET 等
6	新洁能	2017 年度营业收入为 5.04 亿元; 2018 年度营业收入为 7.16 亿元; 2019 年度营业收入为 7.73 亿元(非上市公司)	主要为 Fabless 模式	主要产品包括沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET 和 IGBT 等。
7	瑞能半导体有限公司	国际合资企业, 由恩智浦半导体(NXP)与北京建广资产管理有限公司联合成立(非上市公司)	IDM 模式	主要产品包括可控硅整流器和三端双向可控硅、硅功率二极管、高压晶体管和碳化硅二极管等
8	常州银河世纪微电子股份有限公司	2017 年度营业收入为 6.12 亿元(非上市公司)	IDM 模式	主要产品包括二极管、三极管和桥式整流管等半导体分立器件产品
9	捷捷微电(300623)	上市公司。 2017 年度营业收入为 4.31 亿元; 2018 年度营业收入为 5.37 亿元; 2019 年度营业收入为 6.74 亿元;	IDM 模式	公司主营产品包括晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片、二极管器件和芯片、厚膜组件及功率模块、晶体管器件和芯片等。
10	北京燕东微电子有限公司	国有控股企业(非上市公司)	IDM 模式	主要产品包括模拟集成电路、二极管产品、

				VDMOS 系列、CMOS、 场效应件等产品
--	--	--	--	---------------------------

## 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

### (一) 主要固定资产情况

#### 1、与业务相关的主要固定资产

##### (1) 房屋建筑物

截至本招股书签署日，公司及子公司拥有房屋建筑物 1 处，具体情况如下表：

序号	房屋所有权证号	地址	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	所有权人	用途	取得 方式
1	苏(2019)无锡市 不动产权第 0071063	新吴区研发一路以 东、研发二路以南	8,888.8	电基集成	工业	自建

##### (2) 租赁的房屋建筑物

截至本招股书签署日，公司租赁的房屋建筑物共 3 处，具体情况如下表：

序号	出租方	租赁位置	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁价格	租赁期限
1	深圳市伯广 投资咨询有 限公司	深圳市宝安区西 乡街道西乡大道 与前进二路交汇 处美兰商务中心 802、807 房	240、158	月租金总额为人民 币 25,888 元、16,906 元	2017.12.17- 2020.12.17 和 2018.07.09- 2020.12.17
2	无锡龙世太 湖科技发展 有限公司	无锡市高浪东路 999 号 B1 号楼 2 层	74	每平方米 1 元/日	2019.11.1- 2020.10.31
3	浙江升和资 产管理有限 公司	宁波市金融硅谷 产业园 8 号楼 1007 室	153.4	每平方米 1.9 元/日	2019.09.24- 2022.10.03

公司所有租赁房产的产权人与公司实际控制人、一致行动人、董事、监事、高级管理人员及其家庭关系密切成员之间不存在关联关系。

##### (3) 主要设备

截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有的主要设备情况如下：

序号	设备名称	单位	数量	成新率 <sup>注</sup>
1	半导体动静态一体测试设备	台	1	80.00%
2	测试分选机	台	2	89.17%
3	K&S 球焊键合机	台	10	94.17%
4	SOT23 塑封设备	套	1	94.17%
5	TO252 4*28 全自动切筋成形系统	套	1	92.50%
6	BESTEM-D310 高晶度固晶机	台	3	94.17%
7	全自动装片机 AD832i	台	2	94.17%
8	铝线键合机	台	10	92.50%
9	F206 SOT23 Handler 测试分选机	台	2	94.17%
10	SOT23 24*64 切筋成形系统	台	1	94.17%
11	切割机 DISCO DFD6341	台	2	92.50%
12	全自动装片机 SD832D	台	3	92.50%
13	SOT23 模具	套	2	94.17%
14	F246 TO252 Handler 测试分选机	台	3	92.50%
15	全自动键合机	台	5	99.17%

注：成新率=设备剩余可使用年限/（设备已使用年限+设备剩余可使用年限）

## （二）主要无形资产

### 1、土地使用权

截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有 1 项土地使用权，具体情况如下：

序号	土地使用证号	地址	面积（m <sup>2</sup> ）	终止日期	颁证日期	权属
1	苏（2017）无锡市不动产权第 0167038 号	研发二路以南、研发一路以东	15,271.70	2067 年 9 月 3 日	2017 年 9 月 6 日	电基集成

### 2、与业务相关的知识产权

#### （1）专利权

截至 2020 年 1 月 19 日，公司拥有 97 项专利，其中发明专利 35 项、实用新型 59 项，外观设计 3 项，具体情况如下：

序号	名称	专利号	专利申请日	授权公告日	申请类型	专利权人	取得方式
----	----	-----	-------	-------	------	------	------



1	一种深沟槽功率 MOS 器件及其制造方法	ZL 2010 1 0004030.1	2010.01.08	2011.05.11	发明专利	新洁能	转让取得
2	沟槽型大功率 MOS 器件及其制造方法	ZL 2010 1 0003953.5	2010.01.08	2011.05.11	发明专利	新洁能	转让取得
3	一种具有改进型终端保护结构的沟槽型功率 MOS 器件	ZL 2009 1 0215280.7	2009.12.29	2011.06.22	发明专利	新洁能	转让取得
4	一种具有改进型终端的半导体器件及其制造方法	ZL 2010 1 0169959.X	2010.05.04	2011.06.22	发明专利	新洁能	转让取得
5	一种沟槽型大功率 MOS 器件及其制造方法	ZL 2010 1 0005206.5	2010.01.15	2011.07.20	发明专利	新洁能	转让取得
6	一种超势垒半导体整流器件及其制造方法	ZL 2010 1 0135350.0	2010.03.17	2011.10.26	发明专利	新洁能	转让取得
7	一种沟槽功率 MOS 器件及其制造方法	ZL 2010 1 0160987.5	2010.04.23	2012.01.11	发明专利	新洁能	转让取得
8	一种沟槽型功率 MOS 器件及其制造方法	ZL 2010 1 0136934.X	2010.03.30	2012.02.29	发明专利	新洁能	转让取得
9	沟槽型肖特基势垒整流器及其制造方法	ZL 2010 1 0124527.7	2010.03.04	2012.05.30	发明专利	新洁能	转让取得
10	具有改进型终端的 IGBT 及其制造方法	ZL 2010 1 0509621.4	2010.10.15	2012.07.25	发明专利	新洁能	转让取得
11	低栅极电荷低导通电阻深沟槽功率 MOSFET 器件及其制造方法	ZL 2011 1 0241525.0	2011.08.22	2012.11.07	发明专利	新洁能	转让取得
12	一种改进型终端结构的沟槽功率 MOS 器件	ZL 2010 1 0158456.2	2010.03.12	2012.11.21	发明专利	新洁能	转让取得
13	一种具有改善型集电极结构的 IGBT	ZL 2010 1 0191133.3	2010.06.04	2013.01.02	发明专利	新洁能	转让取得
14	具有超结结构的平面型功率 MOSFET 器件及	ZL 2011 1 0210968.3	2011.07.26	2013.01.23	发明专利	新洁能	转让取得



	其制造方法						
15	一种沟槽结构的功率 MOSFET 器件及其制造方法	ZL 2011 1 0241526.5	2011.08.22	2013.01.30	发明专利	新洁能	转让取得
16	一种具有超结结构的半导体器件及其制造方法	ZL 2011 1 0132941.7	2011.05.20	2013.04.24	发明专利	新洁能	原始取得
17	超高元胞密度深沟槽功率 MOS 器件及其制造方法	ZL 2011 1 0405658.7	2011.12.08	2013.06.05	发明专利	新洁能	原始取得
18	具有超结结构的半导体器件及其制造方法	ZL 2011 1 0367643.6	2011.11.18	2014.03.19	发明专利	新洁能	原始取得
19	一种具有低导通饱和压降的 IGBT 及其制造方法	ZL 2012 1 0058109.1	2012.03.08	2014.08.13	发明专利	新洁能	原始取得
20	具有终端结构的超结半导体器件及其制造方法	ZL 2012 1 0088330.1	2012.03.29	2015.03.04	发明专利	新洁能	原始取得
21	一种新型结构的 VDMOS 器件及其制造方法	ZL 2013 1 0142008.7	2013.04.22	2015.06.17	发明专利	新洁能	原始取得
22	一种超结 MOSFET 器件及其制造方法	ZL 2013 1 0408434.0	2013.09.06	2016.06.08	发明专利	新洁能	原始取得
23	一种具有改进型封装结构的半导体器件及其制造方法	ZL 2014 1 0075114.2	2014.03.03	2016.06.15	发明专利	电基集成	转让取得
24	一种单周期电流控制功率模块装置	ZL 2014 1 0274393.5	2014.06.18	2016.08.24	发明专利	新洁能	原始取得
25	沟槽型 IGBT 器件及其制造方法	ZL 2014 1 0247145.1	2014.06.05	2016.10.05	发明专利	新洁能	原始取得
26	一种具有精确检测功能的 IGBT 及其制造方法	ZL 2014 1 0201967.6	2014.05.13	2017.01.11	发明专利	新洁能	原始取得
27	功率半导体器件及其制造办法	ZL 2014 1 0247892.5	2014.06.05	2017.01.11	发明专利	新洁能	原始取得
28	具有低特征导通电阻的功率	ZL 2014 1 0500191.8	2014.09.25	2017.02.01	发明专利	新洁能	原始取得



	MOSFET 器件及其制造方法						
29	利用电荷耦合实现耐压的功率 MOS 器件及其制备方法	ZL 2015 1 0149864.4	2015.03.31	2017.09.05	发明专利	新洁能	原始取得
30	沟槽功率 MOS 器件及其制造方法	ZL2015 1 0045005.0	2015.01.28	2017.10.20	发明专利	新洁能	原始取得
31	半桥驱动电路	ZL 2015 1 0726410.9	2015.10.30	2018.07.27	发明专利	新洁能	原始取得
32	改善反向恢复特性及雪崩能力的超结 MOS 器件及其制造方法	ZL 2016 1 0021133.6	2016.01.13	2019.02.15	发明专利	新洁能	原始取得
33	具有载流子存储结构的 IGBT 器件及其制造方法	ZL 2016 1 0170267.4	2016.03.23	2019.02.15	发明专利	新洁能	原始取得
34	一种大电流功率半导体器件的封装结构及制造方法	ZL2016 1 0852313.9	2016.09.26	2019.10.11	发明专利	新洁能	原始取得
35	一种优化开关特性的超结半导体器件及制造方法	ZL2016 1 0729581.1	2016.08.25	2019.12.06	发明专利	新洁能	原始取得
36	一种深沟槽的功率半导体器件	ZL2018 2 0164326.1	2018.01.30	2018.09.11	实用新型	新洁能	原始取得
37	一种沟槽型半导体整流器	ZL 2010 2 0131168.3	2010.03.04	2010.11.10	实用新型	新洁能	转让取得
38	具有超结结构的半导体器件	ZL 2010 2 0188114.0	2010.05.04	2010.12.15	实用新型	新洁能	转让取得
39	一种改进型终端结构的功率 MOS 器件	ZL 2012 2 0092694.2	2012.03.13	2012.10.03	实用新型	新洁能	转让取得
40	功率 MOSFET 器件	ZL 2011 2 0476787.0	2011.11.25	2012.10.03	实用新型	新洁能	转让取得
41	能实现电流双向流通的功率 MOSFET 器件	ZL 2015 2 0016806.X	2015.01.09	2015.06.03	实用新型	新洁能	原始取得
42	提高截止效果的沟槽型功率 MOS 器件	ZL 2012 2 0000743.5	2012.01.04	2012.11.14	实用新型	新洁能	转让取得





43	一种超结半导体器件	ZL 2015 2 0408572.3	2015.06.12	2015.10.14	实用新型	新洁能	原始取得
44	具有防静电保护结构的低压 MOSFET 器件	ZL 2016 2 0009622.5	2016.01.06	2016.06.15	实用新型	新洁能	原始取得
45	一种引线框架	ZL 2014 2 0072897.4	2014.02.19	2014.07.23	实用新型	新洁能	原始取得
46	集成磁路多电平开关电源装置	ZL 2014 2 0129205.5	2014.03.20	2014.07.23	实用新型	新洁能	原始取得
47	一种半导体器件封装引线框架	ZL 2014 2 0112295.7	2014.03.13	2014.08.27	实用新型	新洁能	原始取得
48	具有电流采样功能的沟槽型功率 MOSFET 器件	ZL 2014 2 0274024.1	2014.05.26	2014.09.24	实用新型	新洁能	原始取得
49	沟槽型功率 MOSFET 器件	ZL 2016 2 0629808.0	2016.06.23	2016.12.07	实用新型	新洁能	原始取得
50	一种大电流功率半导体器件的封装结构	ZL 2016 2 0733119.4	2016.07.12	2017.02.22	实用新型	新洁能	原始取得
51	电动车过流保护装置	ZL 2014 2 0326953.2	2014.06.18	2014.11.05	实用新型	新洁能	原始取得
52	具有终端结构的场截止型 IGBT 器件	ZL 2014 2 0464575.4	2014.08.15	2014.12.17	实用新型	新洁能	原始取得
53	利用电荷耦合实现耐压的肖特基二极管	ZL 2015 2 0190631.4	2015.03.31	2015.08.12	实用新型	新洁能	原始取得
54	薄型功率模块	ZL 2015 2 0572096.9	2015.07.31	2015.11.18	实用新型	新洁能	原始取得
55	采用功率模块的电机控制器	ZL 2015 2 0559228.4	2015.07.29	2015.12.16	实用新型	新洁能	原始取得
56	功率端子以及利用所述功率端子的功率模块	ZL 2015 2 0647805.5	2015.08.25	2016.01.13	实用新型	新洁能	原始取得
57	适用于电荷耦合器件的半导体结构	ZL 2016 2 0267014.4	2016.03.31	2016.08.17	实用新型	新洁能	原始取得



58	适用于三端功率器件的薄型封装模块	ZL 2016 2 0130576.4	2016.02.19	2016.08.17	实用新型	新洁能	原始取得
59	功率模块	ZL 2016 2 0306528.6	2016.04.13	2016.08.31	实用新型	新洁能	原始取得
61	一种优化开关特性的超结半导体器件	ZL 2016 2 0945153.8	2016.08.25	2017.04.19	实用新型	新洁能	原始取得
62	高集成度的低压沟槽栅 DMOS 器件	ZL 2016 2 1188364.8	2016.11.04	2017.04.26	实用新型	新洁能	原始取得
63	具有低导通压降的绝缘栅双极型晶体管器件	ZL 2016 2 1309158.8	2016.12.01	2017.05.24	实用新型	新洁能	原始取得
64	功率模块用底板及功率模块	ZL 2016 2 0992712.0	2016.08.30	2017.05.24	实用新型	新洁能	原始取得
65	沟槽 DMOS 器件	ZL 2016 2 1188365.2	2016.11.04	2017.05.24	实用新型	新洁能	原始取得
66	具有终端保护区的超结半导体器件	ZL201720132638.X	2017.02.14	2017.09.05	实用新型	新洁能	原始取得
67	一种电荷耦合功率 MOSFET 器件	ZL 2017 2 0413251.1	2017.04.19	2017.11.10	实用新型	新洁能	原始取得
68	电荷耦合功率 MOSFET 器件	ZL 2017 2 0412542.9	2017.04.19	2017.12.01	实用新型	新洁能	原始取得
69	一种降低导通电阻的功率半导体器件	ZL 2017 2 0802726.6	2017.07.04	2018.02.06	实用新型	新洁能	原始取得
70	一种优化终端结构的沟槽型半导体器件	ZL 2017 2 0877752.5	2017.07.19	2018.02.06	实用新型	新洁能	原始取得
71	适用于深沟槽的功率半导体器件结构	ZL 2017 2 0905927.9	2017.07.25	2018.02.06	实用新型	新洁能	原始取得
72	晶体管器件的终端结构	ZL 2017 2 0978114.2	2017.08.07	2018.03.13	实用新型	新洁能	原始取得
73	一种具有多个浓度中心的超结半导体器件	ZL 2017 2 1047506.3	2017.08.21	2018.04.03	实用新型	新洁能	原始取得

74	一种功率半导体器件	ZL 2017 2 1223304.X	2017.09.22	2018.04.03	实用新型	新洁能	原始取得
75	一种晶圆级功率半导体器件	ZL 2017 2 1303825.6	2017.10.10	2018.04.17	实用新型	新洁能	原始取得
76	一种优化器件特性的半导体结构	ZL 2017 2 1423121.2	2017.10.31	2018.05.04	实用新型	新洁能	原始取得
77	一种抗耐压冲击软关断的 IGBT 器件结构	ZL 2017 2 1875361.6	2017.12.27	2018.08.03	实用新型	新洁能	原始取得
78	一种高雪崩耐量的深沟槽功率器件	ZL 2018 2 0487064.2	2018.04.08	2018.10.12	实用新型	新洁能	原始取得
79	一种带沟槽的终端结构	ZL 2018 2 0487063.8	2018.04.08	2018.10.12	实用新型	新洁能	原始取得
80	一种功率半导体器件终端结构	ZL 2018 2 0486621.9	2018.04.08	2018.10.12	实用新型	新洁能	原始取得
81	一种屏蔽栅功率 MOSFET 器件	ZL 2018 2 1288168.7	2018.08.10	2019.02.12	实用新型	新洁能	原始取得
82	一种绝缘栅双极型半导体器件	ZL 2018 2 1320354.4	2018.08.16	2019.03.01	实用新型	新洁能	原始取得
83	高浪涌电流能力碳化硅二极管	ZL 2018 2 1397087.0	2018.08.29	2019.03.15	实用新型	新洁能	原始取得
84	一种高浪涌电流能力碳化硅二极管	ZL 2018 2 1397084.7	2018.08.29	2019.03.15	实用新型	新洁能	原始取得
85	一种 SiC 功率器件终端	ZL 2018 21482781.2	2018.09.11	2019.04.05	实用新型	新洁能	原始取得
86	一种高耐压的碳化硅肖特基二极管	ZL 2018 21666677.9	2018.10.15	2019.04.12	实用新型	新洁能	原始取得
87	耗尽型 MOSFET 器件	ZL 2018 2 1564557.8	2018.09.21	2019.05.03	实用新型	新洁能	原始取得
88	优化热分布的碳化硅肖特基二极管	ZL 2018 2 1843868.8	2018.11.09	2019.05.03	实用新型	新洁能	原始取得
89	一种碳化硅肖特基二极管	ZL 2018 2 1843834.9	2018.11.09	2019.05.03	实用新型	新洁能	原始取得

59	一种半封闭式屏蔽栅 IEGT 器件结构	ZL 2018 2 1851832.4	2018.11.09	2019.05.03	实用新型	新洁能	原始取得
90	一种多次外延的超结终端结构	ZL 2018 2 2023624.1	2018.12.04	2019.07.09	实用新型	新洁能	原始取得
91	一种具有低热阻的半导体器件封装结构	ZL2019 2 0247774.2	2019.02.27	2019.09.06	实用新型	新洁能、电基集成	原始取得
92	一种 IGBT 结构	ZL2019 2 0759868.8	2019.05.24	2019.12.06	实用新型	新洁能	原始取得
93	大电流半导体功率器件	ZL2019 2 0813483.5	2019.05.31	2019.12.20	实用新型	电基集成	原始取得
94	利于焊接的大电流半导体功率器件	ZL2019 2 0812348.9	2019.05.31	2019.12.17	实用新型	电基集成	原始取得
95	封装引线框架	ZL 2014 3 0049102.3	2014.03.13	2014.09.10	外观设计	新洁能	原始取得
96	封装框架 (TO-220)	ZL 2014 3 0030111.8	2014.02.19	2014.09.24	外观设计	新洁能	原始取得
97	封装引线框架 (TO-220)	ZL 2014 3 0039432.4	2014.03.03	2015.02.11	外观设计	新洁能	原始取得

注 1：第 1 项至第 15 项发明专利、第 37 项至第 40 项和第 42 项实用新型专利为新洁能从新洁能半导体转让取得；

注 2：第 23 项发明专利为新洁能原始取得后转让至全资子公司电基集成。

## (2) 商标权

截至本招股书签署日，公司拥有 12 项商标权，具体情况如下：

序号	注册证号	注册商标	注册类别	注册公告日	有效期至	权利人
1	7962650		第 9 类	2011 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 27 日	新洁能
2	7962678		第 9 类	2011 年 6 月 14 日	2031 年 6 月 13 日	新洁能

3	7962696		第9类	2011年10月28日	2021年10月27日	新洁能
4	9700201		第9类	2012年8月21日	2022年8月20日	新洁能
5	12789607		第9类	2014年12月14日	2024年12月13日	新洁能
6	32978713		第9类	2019年5月14日	2029年5月13日	电基集成
7	32978714A		第9类	2019年7月14日	2029年7月13日	电基集成
8	32287895A		第9类	2019年8月7日	2029年8月6日	电基集成
9	32287896A		第9类	2019年8月7日	2029年8月6日	电基集成
10	32287897		第9类	2019年10月7日	2029年10月6日	电基集成
11	38627474A		第9类	2020年3月7日	2030年3月6日	新洁能
12	40427995		第9类	2020年4月7日	2030年4月6日	新洁能

### (3) 发表的核心期刊

截至本招股书签署日，公司参与在 IEEE TDMR 等国际知名期刊中发表论文 13 篇，其中 SCI 收录论文 7 篇，具体如下：

序号	论文名称	发表时间	发表期刊	收录情况
1	Investigation on the Breakdown Failure in Stripe Trench-Gate Field-Stop Insulated Bipolar Transistor With Low-Saturation Voltage	2016 年	IEEE TDMR	SCI
2	Failure Analysis and Improvement for High Power Single-Phase Module	2017 年	IEEE TDMR	SCI

3	1200 V FS-IGBT with electric field modulation layer to improve trade-off between avalanche ruggedness and on-state voltage drop	2017 年	IET EL	SCI
4	Novel failure mechanism and improvement for split-gate trench MOSFET with large current under unclamped inductive switch stress	2018 年	Superlattices and Microstructures	SCI
5	A low loss IGBT with shallow p-well to adjust the carrier profiles at the emitter side	2016 年	ISPSD 2016	EI
6	Design criterion of the superjunction DMOS for low EMI noise in the flyback converter system	2016 年	ISPSD 2016	EI
7	A novel split-gate structure for 85V application with low output capacitance	2016 年	EDSSC 2016	EI
8	Investigations of inhomogeneous reverse recovery behavior of the Body Diode in Superjunction MOSFET	2017 年	ISPSD 2017	EI
9	Influence of forward current freewheeling time on di/dt robustness of SJ-MOSFET body diode	2017 年	IPFA 2017	EI
10	Failure Mechanism Investigations of Type II Short-Circuit in TrenchGate IGBT Device	2018 年	ICSICT2018	EI
11	SJ-MOSFET with wave-type field limiting ring for high di/dt robustness of body diode reverse recovery	2018 年	SSE	SCI
12	Analysis and Optimization of the Switching Noise for Super-Junction MOSFET in Full Bridge Converter System	2019 年	SSE	SCI
13	Breakdown Voltage Walk-in Phenomenon and Optimization for the Trench-gate P-type MOSFET under single avalanche stress.pdf	2020 年	IEEE TED	SCI

### (三) 发行人获得的主要荣誉和资质

截至本招股说明书签署日，公司获得的部分荣誉和资质情况如下表所示：

序号	证书名称	获得时间	颁发机构
1	2019 年中国半导体功率器件十强企业	2020 年 3 月	中国半导体行业协会
2	江苏省科学技术一等奖	2020 年 3 月	江苏省人民政府
3	2018 年中国半导体功率器件十强企业	2019 年 5 月	中国半导体行业协会
4	江苏省功率器件工程技术研究中心	2018 年 10 月	江苏省科学技术厅
5	2017 年中国半导体功率器件十强企业	2018 年 4 月	中国半导体行业协会
6	2017 年度先进会员单位	2018 年 3 月	江苏省半导体行业协会
7	2017 年度中国半导体行业协会会员证	2017 年	中国半导体行业协会
8	中国电源学会理事单位	2017 年 6 月	中国电源学会

9	无锡市功率器件工程技术研究中心	2017年6月	无锡市科学技术局
10	2016年中国半导体功率器件十强企业	2017年3月	中国半导体行业协会
11	高新技术企业证书	2017年11月、 2014年9月	江苏省科学技术厅 江苏省财政厅 江苏省国家税务局 江苏省地方税务局
12	2016年度中国半导体行业协会会员证	2016年	中国半导体行业协会
13	第九届无锡市专利奖-优秀奖	2016年	无锡市人民政府
14	ISO 质量体系证书	2016年10月、 2013年10月	英国标准协会 (BSI)
15	江苏省企业研究生工作站	2015年7月	江苏省教育厅
16	江苏省半导体行业协会会员证	2015年1月	江苏省半导体行业协会

#### (四) 发行人产品获得的主要荣誉

截至2019年12月31日，公司产品获得的部分荣誉和资质情况如下表所示：

序号	项目名称	编号	获得时间	颁发机构
1	高新技术产品认定证书- 屏蔽栅沟槽型功率 MOSFET	150211G0050N	2015年6月	江苏省科学技术厅
2	高新技术产品认定证书- 超结功率 MOSFET	140211G0060N	2014年5月	江苏省科学技术厅
3	高新技术产品认定证书- 沟槽型功率 MOSFET	140211G0058N	2014年5月	江苏省科学技术厅
4	高新技术产品认定证书- 绝缘栅双极型晶体管 (IGBT)	140211G0059N	2014年5月	江苏省科学技术厅

## 六、同业竞争与关联交易

### (一) 同业竞争

#### 1、公司与控股股东、实际控制人及一致行动人之间不存在同业竞争

公司控股股东、实际控制人朱袁正直接持有公司31.11%股权。同时朱袁正分别与叶鹏、王成宏、戴锁庆、周洞濂、顾朋朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆虹、肖东戈共计10名股东签订有关一致行动的协议，约定上述十位股东在公司股东大会或董事会表决时，应主动与朱袁正保持一致，因此朱袁正可控制的股权比例为

35.62%。截至本招股说明书签署日，朱袁正及一致行动人未从事任何与公司相同、相似的业务，与公司之间不存在同业竞争。

## 2、公司与控股股东、实际控制人及一致行动人控制的其他企业之间不存在同业竞争

控股股东、实际控制人朱袁正及一致行动人未控制其他企业。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）采购商品/接受劳务情况

报告期内，公司与关联方之间发生的采购交易具体情况如下：

单位：万元

关联方	主要交易内容	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
		金额	占采购总额的比例	金额	占采购总额的比例	金额	占采购总额的比例
长电科技 <sup>注1</sup>	封测服务	-	-	2,522.69	4.43%	4,306.98	10.65%
灿升实业 <sup>注2</sup>	封测服务	-	-	-	-	14.92	0.04%
红光股份 <sup>注3</sup>	封测服务	82.58	0.13%	435.13	0.76%	-	-
合计		82.58	0.13%	2,957.82	5.19%	4,321.89	10.69%

注 1：长电科技于 2017 年 7 月不再为公司关联方，本招股书基于谨慎性原则，延长披露 1 年，表格中披露金额为 2018 年 1-7 月采购数据。长电科技采购金额包括公司对其控股子公司新顺微电子、长电先进的采购金额。

注 2：灿升实业系公司实际控制人朱袁正的原一致行动人、原持有公司 0.79% 股权的股东洪雪君及其配偶控制的企业，2018 年 7 月 5 日，洪雪君签订补充协议，解除一致行动人关系；本招股书基于谨慎性原则，延长披露 1 年。

注 3：2018 年 5 月 22 日，公司股东达晨创投委派董事王文荣担任红光股份董事。2018 年 9 月 28 日，根据红光股份（831034）公告，王文荣辞去红光股份董事，本招股书基于谨慎性原则，延长披露 1 年，故 2018 年披露交易金额为 2018 年 5-12 月公司向红光股份的采购金额，2019 年披露为 2019 年 1-9 月的采购金额。

#### ①向长电科技采购封测服务

公司是以半导体芯片和功率器件研发设计为主的企业，需对外采购封测服务。公司选择长电科技作为封测服务供应商的主要原因为长电科技是全球排名第三、国内排名第一的封测服务龙头企业，其封装测试业务的先进工艺和高良品率能够



保证公司的产品质量和性能。

2017年至2018年1-7月，公司向长电科技主要采购封测服务，总金额分别为4,306.98万元和2,522.69万元，占当年采购总额的比例分别为10.65%和4.43%，2018年全年，公司向长电科技采购金额为4,107.78万元，占当年采购总额的比例为7.21%，2019年，公司向长电科技采购金额为3,936.98万元，占当期采购总额的比例为6.01%，采购占比持续降低。公司向长电科技采购定价系参考市场价格协商确定，交易价格公允。报告期内，公司积极拓展其他封测供应渠道，现已与安靠技术（Amkor）、通富微电（002156）、上海捷敏等十余家封测企业开展持续稳定合作；此外，2016年起，公司逐步投入封装测试技术研发，并于2018年下半年开始自建封装测试产线，未来将减少封测委外代工。具体分析如下：

#### I、公司向长电科技采购封测服务占公司同类采购业务的比例

报告期内，公司与长电科技发生关联采购业务的具体情况如下：

单位：万元

关联方	主要交易内容	2018年1-7月		2017年度	
		金额	占当年同类采购的比	金额	占当年同类采购的比
长电科技	封测服务	2,499.65	19.90%	4,301.33	55.48%
	芯片	23.04	14.61%	5.64	6.94%

注1：长电科技于2017年7月不再为公司关联方，本招股书基于谨慎性原则，延长披露1年，表格中披露金额为2018年1-7月采购数据。向长电科技采购金额包括公司对其控股子公司新顺微电子、长电先进的采购金额。

根据上表，2017年至2018年1-7月，公司向长电科技采购封测服务的金额分别为4,301.33万元和2,499.65万元，占当年同类采购额的比分别为55.48%和19.90%，采购金额和占比逐年下降。2018年全年，公司向长电科技采购封测服务的总金额为4,083.44万元，占当年同类采购额的比例为32.51%；2019年，公司向长电科技采购封测服务金额为3,936.98万元，占当年同类采购额的比例为30.67%，采购金额和占比整体下降。

#### II、采购的定价依据

公司与长电科技采购定价依据主要为市场情况协商定价，具体的定价依据如下：

公司向长电科技采购定价过程：公司与长电科技签订框架协议，每年与长电科技协商确定本年度的采购基准单价，采购基准单价经双方内部经营决策通过后一般不会变化，若出现需采购的特殊要求的产品时长电科技会依据产品具体要求重新协商确定采购价格。

公司向长电科技采购定价主要考虑：封装形式的类别、封装产品的主要材料及其价格波动、产品测试时间长短及测试效率、特殊工艺要求等，并综合考虑长电科技的产能规模、工艺水平、质量及品质（良品率等）、品牌效应、管理水平等因素。

### III、采购价格公允性说明

根据对长电科技的访谈及获取其出具的《基本信息情况表》，公司向长电科技的采购价格均处于其向其他客户销售均价范围之内，且较中值差异很小，公司向长电科技的采购价格与长电科技向非关联方客户销售同类服务价格不存在重大差异。

公司向长电科技采购单价与向其他非关联供应商采购同类封测服务的均价亦不存在重大差异，将长电科技的采购单价替换为非关联供应商平均采购单价测算后，相关金额差异亦较小，占公司当期营业成本的比例分别为 0.86%、0.38% 和 0.54%，占比极低。

综上，公司向长电科技采购交易价格公允，不存在向公司输送利益的情形。

#### ②向灿升实业采购封测服务

灿升实业系公司实际控制人朱袁正的原一致行动人、原持有公司 0.79% 股权的股东洪雪君及其配偶控制的企业；2018 年 6 月和 9 月，洪雪君将其持有的公司全部股份转让至无关联第三方。报告期内，由于公司主要封测服务供应商排产因素，公司部分零星加急订单选择向灿升实业采购。2017 年，公司向灿升实业采购封测服务的金额为 14.92 万元，占当期采购总额的比例分别为 0.04%，占比极低，交易价格公允。2018 年及 2019 年，公司未向灿升实业采购封测服务。具体分析如下：

#### I、公司向灿升实业采购封测服务占公司同类采购业务的比例

单位：万元

关联方	主要交易内容	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
		金额	占同类采购额的比	金额	占同类采购额的比	金额	占同类采购额的比
灿升实业	封测服务	-	-	-	-	14.92	0.19%

根据上表，公司向灿升实业采购封测服务金额和占比极低，且 2018 年起不再发生采购业务。

## II、采购的定价依据

公司与灿升实业采购定价依据主要为市场情况协商定价，具体的定价依据如下：

由于灿升实业拥有半导体功率器件封装测试产线，对于临时性、交期较为紧张的订单，公司会向灿升实业采购少量如“SOT-23-3L”等的工艺成熟简单但交期较为紧急的封测服务。由于公司向灿升实业采购具有临时性，因此主要通过订单采购的形式，交易价格依据订单确定。

公司向灿升实业采购定价主要考虑：封装形式的类别、封装产品的主要材料及其价格波动、产品测试时间长短及测试效率、产品交期要求等因素。

## III、采购价格公允性说明

根据对灿升实业的访谈及获取其出具的《基本信息情况表》，公司向灿升实业采购的主要封装形式的价格均处于其向其他客户销售均价范围之内，且较中值差异很小。因此，公司采购灿升实业封测服务的价格与其他第三方不存在重大差异，采购交易价格公允，不存在向公司输送利益的情形。

### ③向红光股份采购封测服务

2016 年起，红光股份始终为公司封测服务供应商。公司董事王文荣系公司股东达晨创投委派，达晨创投于 2017 年 11 月投资红光股份，并委派王文荣于 2018 年 5 月 22 日担任其董事。2018 年 9 月 28 日，根据红光股份公告，王文荣辞去红光股份董事职务。2018 年 5-12 月和 2019 年 1-9 月，公司向红光股份采购封测服务，交易金额分别为 435.13 万元和 82.58 万元，占当年采购总额的比例为 0.76% 和 0.13%，占比极低。2019 年，公司向红光股份采购总额为 113.55 万元，占当年

采购总额的比例为 0.17%。公司向红光股份采购定价系参考市场价格协商确定，交易价格公允。具体分析如下：

### I、公司向红光股份采购封测服务占公司同类采购业务的比例

2018 年 5-12 月，公司向红光股份采购封测服务的金额为 435.13 万元，占当年同类采购额的比例为 3.46%；2019 年 1-9 月，公司向红光股份采购封测服务的金额为 82.58 万元，占当年同类采购额的比例为 0.64%；2019 年，公司向红光股份采购总额为 113.55 万元，占当年同类采购额的比例为 0.88%，采购占比较低。

### II、采购价格的定价依据

公司与红光股份采购和销售定价主要依据市场情况协商定价，具体的定价依据如下：

红光股份（831034）为无锡地区的半导体封装测试企业，2014 年于全国中小企业股份转让系统挂牌。公司于 2016 年开始与其开展合作，主要向其采购“TO-252”、“SOT-23”、“SOP-8”等形式的封测服务。公司每年与其协商确定相关封装形式的采购单价，由于“TO-252”、“SOT-23”、“SOP-8”属于相对成熟的封装形式，因此其交易定价较为稳定。

公司向红光股份采购定价主要考虑：封装形式的类别、封装产品的主要材料及其价格波动、产品测试时间长短及测试效率以及综合考虑红光股份的产品工艺、品质、产能规模及质量管控等。

### III、采购价格公允性说明

根据对红光股份的访谈及获取其出具的《基本信息情况表》，公司向红光股份的采购定价与红光股份向非关联方客户销售同类服务均价不存在重大差异。

公司向红光股份采购单价与向其他非关联供应商采购同类封测服务的均价亦不存在重大差异，2018 年和 2019 年，将红光股份的采购单价替换为非关联供应商采购均价测算后，相关采购金额差异较小，占当期营业成本的比例为-0.08%和-0.04%，占比极低。因此，公司向红光股份采购交易价格公允，不存在向公司输送利益的情形。

## (2) 销售商品/提供劳务

报告期内，公司与关联方之间发生的销售交易具体情况如下：

单位：万元

关联方	主要交易内容	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
		金额	占销售总额的比例	金额	占销售总额的比例	金额	占销售总额的比例
长电科技 <sup>注1</sup>	芯片及成品	-	-	957.73	1.34%	2,204.92	4.38%
上海贝岭	芯片及成品	144.91	0.19%	437.12	0.61%	777.15	1.54%
灿升实业 <sup>注2</sup>	芯片	417.57	0.54%	473.80	0.66%	1,181.10	2.34%
合计		<b>562.48</b>	<b>0.73%</b>	<b>1,868.65</b>	<b>2.61%</b>	<b>4,163.17</b>	<b>8.26%</b>

注 1：长电科技于 2017 年 7 月不再为公司关联方，本招股书基于谨慎性原则，延长披露 1 年，表格中披露金额为 2018 年 1-7 月销售金额。公司主要与长电科技及其子公司芯长电子、宿迁长电、深圳长电发生销售交易，故合并披露。

注 2：灿升实业于 2018 年 7 月不再为公司关联方，本招股书基于谨慎性原则，延长披露 1 年，表格中披露金额为 2019 年 1-7 月销售金额。

#### ①向长电科技销售芯片及成品

报告期内，公司向长电科技及其子公司销售芯片及少量功率器件，主要原因：长电科技及其子公司部分从事二极管、三极管以及少量 MOSFET 等的销售，而公司是国内 MOSFET 产品的主要供应商之一，因此上述公司向新洁能采购部分芯片并封装测试后再自行销售。2017 年至 2018 年 1-7 月，公司向长电科技合计销售金额分别 2,204.92 万元和 957.73 万元，占当年营业收入的比例分别为 4.38% 和 1.34%，2018 年全年，公司向长电科技销售金额为 1,741.47 万元，占当年销售收入的 2.43%，2019 年，公司向长电科技销售金额为 2.32 万元，占当年销售收入的 0.003%，交易占比整体较低且持续下降，未对公司经营业绩产生重大影响。公司向长电科技的销售价格系参照市场价格协商确定，交易价格公允。具体分析如下：

#### I、公司向长电科技销售芯片及功率器件占公司同类销售业务的比例

报告期内，公司与长电科技发生关联销售业务的具体情况如下：

单位：万元

关联方	主要交易内容	2018 年 1-7 月		2017 年度	
		金额	占当年同类销售的比例	金额	占当年同类销售的比例
长电科技	芯片	902.57	4.21%	2,167.06	10.09%
	功率器件	55.16	0.11%	37.86	0.13%

公司向长电科技主要销售芯片。2017年至2018年1-7月，公司主要向长电科技销售芯片的金额分别为2,167.06万元和902.57万元，占当年同类销售收入的比分别为10.09%和4.21%，销售金额和占比逐年下降。2018年全年，公司向长电科技销售芯片的总金额为1,674.22万元，占当年同类销售收入的比为7.80%，2019年，公司向长电科技销售芯片金额为2.32万元，占当年同类销售收入的比率为0.01%，销售金额和占比较上年持续下降。

## II、销售价格的定价依据

公司与长电科技销售定价主要依据市场价格及供求关系协商确定，具体的定价依据如下：

公司向长电科技销售定价过程：由于长电科技与公司合作时间较长，为公司长期稳定的重要客户，且其为国内A股上市公司，资金实力、品牌影响力及商业美誉度均较高，因此公司将其作为战略客户，并依照市场价格（同类战略客户销售单价），结合市场供求关系协商确定其产品销售价格。公司与长电科技签订框架协议，每年根据市场价格与长电科技协商确定本年度的销售基准单价。在实际订单合作中，公司会依据市场供需关系、芯片代工成本波动以及其他非关联战略客户销售单价波动等因素，协商调整销售价格。

公司向长电科技销售定价主要考虑：市场价格、市场供需关系、芯片的类别、芯片代工的的成本等并综合考虑长电科技的回款能力、订货数量、品牌效应等因素。

## III、销售价格公允性说明

从细分产品类别看，公司向长电科技主要销售沟槽型功率MOSFET芯片，公司向长电科技销售沟槽型功率MOSFET芯片单价较其他非关联战略客户销售同类产品的均价比较如下：

单位：元/片

公司名称	2018年1-7月	2017年
长电科技	2,385.24	1,803.71
其他非关联战略客户	2,327.81	1,778.95
差异率	2.47%	1.39%

公司对长电科技的销售定价与公司向其他非关联战略客户销售同类产品的单

价不存在重大差异，销售交易价格公允，不存在向公司输送利益的情形。

## ②向上海贝岭销售芯片及成品

上海贝岭系持有公司 7.91% 股份的股东，公司主要向其销售芯片及少量功率器件，主要原因为：上海贝岭主要从事 IC 设计业务，其生产经营中需将 IC、MCU 以及 MOSFET 等电子元器件进行组合销售。由于公司是国内 MOSFET 产品的主要供应商之一，因此，上海贝岭向公司采购 MOSFET 芯片及少量功率器件。报告期各期，公司向上海贝岭销售金额分别为 777.15 万元、437.12 万元和 144.91 万元，占当期销售收入的比例分别为 1.54%、0.61% 和 0.19%，交易占比较低且持续下降。公司向上海贝岭的销售价格系参照市场价格协商确定，交易价格公允。具体分析如下：

### I、公司向上海贝岭销售芯片和功率器件占同类销售业务的比例

报告期内，公司与上海贝岭发生的关联销售业务的具体情况如下：

单位：万元

关联方	主要交易内容	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
		金额	占同类销售收入的比	金额	占同类销售收入的比	金额	占同类销售收入的比
上海贝岭	芯片	144.08	0.71%	429.70	2.00%	724.04	3.37%
	功率器件	0.83	0.001%	7.42	0.01%	53.11	0.18%

2017 年至 2019 年，公司主要向上海贝岭销售芯片，销售芯片金额分别为 724.04 万元、429.70 万元和 144.08 万元，占同类销售收入比例分别为 3.37%、2.00% 和 0.71%，销售金额和占比均较小，且逐年降低。

### II、销售价格的定价依据

经核查，公司与上海贝岭销售定价主要依据市场情况协商定价的形式，具体的定价依据如下：

公司向上海贝岭销售定价过程：由于上海贝岭为 A 股上市公司，在半导体行业具有品牌影响力，公司与其合作对开拓市场及提升品牌美誉度具有帮助；此外，上海贝岭是公司合作多年的优质客户，需求稳定、回款状况良好，因此公司将其作为战略客户，并依照市场价格（同类战略客户销售单价），结合市场供求关系协

商确定其产品销售价格。公司与上海贝岭签订框架协议，并依据具体订单协商确定销售单价，在实际过程中，公司根据市场供需关系、市场价格波动以及芯片代工成本波动等因素并综合考虑上海贝岭的需求及回款情况，调整芯片及功率器件的销售单价并与上海贝岭重新协商确定销售价格。

公司向上海贝岭销售定价主要考虑：芯片的类别、芯片代工的成成本、市场供需关系、其他非关联战略客户销售价格等，并综合考虑上海贝岭的回款能力、订货数量、品牌效应等因素。

### III、销售价格公允性说明

从细分产品类别看，公司向上海贝岭主要销售沟槽型功率 MOSFET 芯片，公司向上海贝岭销售沟槽型功率 MOSFET 芯片单价较向其他非关联战略客户销售同类产品的均价比较如下：

单位：元/片

公司名称	2019 年度	2018 年度	2017 年度
上海贝岭	1,923.66	2,412.67	1,729.25
其他非关联战略客户	1,960.61	2,334.66	1,778.95
差异率	-1.88%	3.34%	-2.79%

根据上表，2017 年至 2019 年，公司向上海贝岭销售沟槽型功率 MOSFET 芯片的销售价格与公司向其他非关联战略客户销售同类产品的均价差异较小，销售价格公允，不存在向公司输送利益的情形。

#### ③向灿升实业销售芯片

报告期内公司向灿升实业销售芯片，灿升实业采购公司芯片后自主封装并将封装后的成品对外销售。2017 年至 2019 年 1-7 月，公司向灿升实业销售金额分别为 1,181.10 万元、473.80 万元和 417.57 万元，占当期销售收入的比例分别为 2.34%、0.66%和 0.54%。报告期内，公司向灿升实业销售芯片整体交易占比较低，销售价格系参照市场价格协商确定，交易价格公允。具体分析如下：

#### I、公司向灿升实业销售芯片占公司同类销售业务的比例

报告期内，公司与灿升实业发生关联销售业务的具体情况如下：



单位：万元

关联方	主要交易内容	2019年1-7月		2018年度		2017年度	
		金额	占同类销售收入的比	金额	占同类销售收入的比	金额	占同类销售收入的比
灿升实业	芯片	417.57	2.06%	473.80	2.21%	1,181.10	5.50%

2017年至2019年1-7月，公司向灿升实业销售芯片金额分别为1,181.10万元、473.80万元和417.57万元，占当年同类销售收入的比例分别为5.50%、2.21%和2.06%，整体呈下降趋势。2019年全年，公司向灿升实业销售产品金额为934.36万元。

## II、销售价格的定价依据

公司与灿升实业销售定价依据主要为依据市场价格及供求关系协商，具体的定价依据如下：

公司向灿升实业销售定价过程：由于灿升实业是公司在华南市场开拓积累的优质客户，其成立于2002年，拥有较为先进的封装设备产线，为深圳市高新技术企业；灿升实业与国内众多知名品牌企业建立合作，产品广泛应用于电池、适配器、充电器、移动电源等领域。由于灿升实业与公司合作期限较长，且其业务规模、采购需求、回款能力均较强，在华南市场具有一定影响力，因此公司将其作为战略客户，并依照市场价格（同类战略客户销售单价），结合市场供求关系协商确定其产品销售价格。在实际订单中，公司根据市场供需关系、芯片代工成本波动以及灿升实业的回款能力等因素，综合调整销售价格。由于报告期初，公司竞争对手通过降低价格的形式与公司竞争灿升实业，公司考虑到华南市场开拓、品牌影响力建设、且该客户回款能力较好，经友好协商给予灿升实业相对较低但合理的销售价格，灿升实业则主要以银行转账方式回款，回款周期很短。

公司向灿升实业销售定价主要考虑：芯片的类别、芯片代工的成成本、市场供需关系、其他非关联战略客户的销售价格、华南地区的市场开拓意义以及灿升实业的回款能力、市场地位及合作期限等因素。

## III、销售价格公允性说明

从细分产品类别看，公司主要向灿升实业销售沟槽型功率 MOSFET 芯片，公

公司向灿升实业销售沟槽型功率 MOSFET 芯片单价较其他非关联战略客户销售同类产品的均价比较如下：

单位：元/片

公司名称	2019 年	2018 年	2017 年
灿升实业	1,819.55	2,209.86	1,730.30
其他非关联战略客户	1,960.61	2,334.66	1,778.95
差异率	-7.19%	-5.35%	-2.73%

根据上表，2017 年至 2018 年，公司向灿升实业销售沟槽型功率 MOSFET 芯片的均价较其他非关联战略客户的销售均价不存在重大差异。

2019 年，公司向灿升实业销售沟槽型功率 MOSFET 芯片的均价低于向其其他非关联战略客户的销售均价，主要原因系受到中美贸易摩擦等因素的影响，公司华南地区的部分涉及外销业务的客户，其采购芯片的需求及采购单价下降幅度较大。公司向灿升实业销售沟槽型功率 MOSFET 芯片的均价与向华南地区的其他非关联客户的销售单价 1,836.94 元/片差异率为-0.95%，整体差异较小。

综上，公司对灿升实业的销售定价与公司向其他同类客户销售同类产品的单价不存在重大差异，交易价格公允，不存在向公司输送利益的情形。

### （3）关联管理人员薪酬

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
关键管理人员税前薪酬总额	521.79	636.96	504.07

（4）公司与长电科技采购封测服务并对其销售芯片及成品的具体内容及两者间是否存在直接相关性，相关采购、销售的交易性质属于购销交易还是加工

公司主要向长电科技采购“TO-220”、“TO-252”、“SOP-8”、“SOT-23”等封装形式的封测服务，公司向长电科技采购封测服务主要原因为公司是以半导体芯片和功率器件研发设计为主的企业，需对外采购封测服务，长电科技是全球排名第三、国内排名第一的封测服务龙头企业，其封装测试业务的先进工艺和高良品率能够保证公司的产品质量和性能。除封测服务外，公司亦向长电科技原子公司新顺微采购少量二极管芯片用于与公司 IGBT 芯片进行合封，相关采购金额较小。

公司主要向长电科技销售沟槽型功率 MOSFET 芯片，主要原因为长电科技及其子公司部分从事二极管、三极管以及少量 MOSFET 等的销售，而公司是国内 MOSFET 产品的主要供应商之一，因此上述公司向新洁能采购部分芯片并自行封装测试后销售。公司向长电科技主要采购封测服务，而向长电科技销售的是芯片和功率器件，采购和销售内容属于不同性质业务，完全区别且交易相互独立，不存在直接相关性。

公司向长电科技采购的具体采购过程为：公司与长电科技签订合作协议，运营处将封装订单、封装规格书（包括封装形式、工艺参数、测试规范等）提供给长电科技并将需要封装测试的芯片提供给长电科技，长电科技依据具体的封装订单将公司提供的芯片通过划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋、测试、包装等一系列加工过程生产出公司所需的功率器件，在采购封装测试的过程中，封装所需的芯片由公司提供，长电科技提供塑封料、引线（铜线）等辅材，并按照协议约定以加工数量\*加工单价的方式计算收取加工费（其中耗用的塑封料、引线等不单独计价，含在加工费里），因此公司向长电科技采购封测服务属于“委托加工”的业务范畴。

公司向长电科技销售的具体销售过程为：公司与长电科技及子公司签订销售协议，长电科技及其子公司芯长电子、宿迁长电、深圳长电主要向公司采购芯片产品并自行封装测试后对外销售。2019 年，长电科技自身业务转型，主动减少功率器件的销售业务，仅向公司采购少量芯片用于工艺研发，采购金额大幅下降。根据公司与长电科技签订的销售协议，公司向长电科技提供协议约定的芯片和功率器件，长电科技依据具体产品及单价支付款项，公司向长电科技销售业务属于购销交易。

#### **（5）早期关联销售占比较高及对各关联方减少销售的原因及合理性**

下游客户向公司采购芯片后根据用途不同可分为以下两类：第一类客户主要采购芯片用于封装测试后销售或与其他产品合并销售；第二类客户主要采购芯片后用于与 IC 等芯片合封形成集成电路模块进行销售，该部分客户产品功能与公司存在区别。报告期初，公司主要芯片客户为第一类客户，公司为缓解经营资金压力，并快速扩展市场，与该部分客户开展合作；2017 年至 2018 年，随着公司逐步提高功率器件的销售占比，公司优化芯片客户结构，减少市场竞争，芯片销售

主要向第二类客户侧重。

报告期早期关联销售占比较高主要原因为：报告期早期，公司以芯片销售为主，主要向长电科技、灿升实业、上海贝岭销售芯片产品，上述关联方属于第一类客户。公司早期为缓解经营资金压力，并快速扩展市场，对上述关联方销售占比相对较高。

报告期内，公司对各关联方减少销售的主要原因系：1) 公司销售结构调整：随着公司功率器件细分型号不断丰富、品牌知名度不断提升以及公司逐步具备满足芯片产品进一步封装所需的资金实力，公司主动调整芯片产品和功率器件的比例结构，逐步降低了芯片的销售占比，提高了功率器件的销售占比，从而能够获得更多产品毛利。2017年至2019年，公司芯片销售金额分别为：21,478.31万元、21,462.91万元和20,246.66万元，占主营业务收入的比例分别为42.68%、30.01%和26.24%，金额及占比均逐年下降。公司早期因以销售芯片为主，因此相应地向包括关联方在内的客户销售芯片产品金额相对较多；随着公司销售结构的调整，公司逐年减少了芯片销售规模，引致向包括关联方在内的客户销售芯片金额相应下降。2) 市场因素：由于指纹识别、手机双摄等新兴应用兴起挤压了8英寸的芯片代工的产能以及公司主动降低芯片销售的比例，加之手机、PC等消费电子领域市场需求持续旺盛，2017年起，公司MOSFET芯片销售逐渐出现供不应求的状况。加之公司优化客户结构，逐步加大与采购公司芯片用于IC合封的客户的合作，减少了对长电科技、灿升实业、上海贝岭等采购公司芯片用于直接封装或组合销售的客户的金额及占比。3) 客户因素：2019年，公司对长电科技的销售金额和占比大幅下降主要原因为长电科技自身业务转型，主动减少功率器件的销售业务，仅向公司采购少量芯片用于工艺研发，因此销售金额及占比大幅下降；2019年，公司对上海贝岭的销售金额和占比大幅下降主要原因为半导体行业周期性波动的背景下，上海贝岭专注于集成电路IC设计主业，减少了购买MOSFET并组合销售的业务量，因此减少了对公司产品的采购。

## 2、关联方应收应付款项余额

报告期内，公司关联方期末往来余额如下：

单位：万元

项目	关联方	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
应收账款	长电科技 <sup>注</sup>	-	-	408.31
	上海贝岭	60.79	32.75	189.88
	灿升实业 <sup>注</sup>	-	207.96	89.84
应付账款	长电科技 <sup>注</sup>	-	-	1,095.29
	灿升实业	-	-	-
	红光股份 <sup>注</sup>	-	35.16	-

注：长电科技于 2017 年 7 月不再为公司关联方，此处不披露其 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的期末往来余额；灿升实业、红光股份分别于 2018 年 7 月、2018 年 9 月不再为公司关联方，此处不披露其 2019 年 12 月 31 日的期末往来余额。

### （三）独立董事对关联交易发表的意见

2018年11月2日，发行人独立董事发表《独立董事关于确认公司最近三年及一期关联交易的意见》，认为：公司报告期发生的关联交易是基于公司正常的生产经营需要而进行，并经管理层充分论证和谨慎决策。上述关联交易履行了相关决策程序或已经其他非关联股东认可，符合公司章程等有关制度的规定，关联交易的发生有其必要性，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在显失公平以及损害发行人和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。

## 七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	简要经历	兼职情况	薪酬 情况 (万元) [注1]	持股 比例 [注2]	与公司的 其他 利益关系
----	----	----	----	------------	------	------	--------------------------	------------------	--------------------



朱袁正	董事长兼 总经理	男	55	2019年3月 15日-2022 年3月14日	曾任中国华晶电子集团公司助理工程师、刻蚀工艺主管，新加坡微电子研究院（Institute of Microelectronics,IME）工程师，德国西门子松下有限公司（Siemens Matsushita Components GmbH）产品工程技术经理，无锡华润上华半导体有限公司研发副处长，苏州硅能半导体科技有限公司董事、总经理，新洁能半导体董事、董事长兼总经理，电芯联智控董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，新洁能香港董事，电基集成执行董事兼总经理。	新洁能香港董事， 电基集成执行董事 兼总经理	79.57	31.11%	无
叶鹏	董事兼副 总经理	男	37	2019年3月 15日-2022 年3月14日	曾任无锡华润上华半导体有限公司项目经理，新洁能半导体董事、副总经理，电芯联智控董事。现任公司董事兼副总经理。	未在其他单位兼职	69.72	1.62%	无
王成宏	董事兼副 总经理	男	51	2019年3月 15日-2022 年3月14日	曾任中国华晶电子集团公司生产管理调度员，东芝半导体（无锡）有限公司制造课长，新洁能半导体运营总监，公司监事、运营总监。现任公司董事兼副总经理。	未在其他单位兼职	65.52	0.63%	无
顾朋朋	董事	男	32	2019年3月 15日-2022 年3月14日	曾任新洁能半导体销售工程师、销售处长。现任公司董事兼新洁能深圳分公司负责人。	未在其他单位兼职	55.01	0.32%	无
王文荣	董事	男	33	2019年3月 15日-2022 年3月14日	曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管理有限公司投资经理，红光股份董事。现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司业务合伙人，上海浪擎信息科技有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事，北京谛声科技有限责任公司董事，无锡威峰科技股份有限公司董事，公司董事。	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司业务合伙人，上海浪擎信息科技有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事，北京谛声科技有限责任公司董事，无锡威峰科技股份有限公司董事	-	-	无



宋延延	董事	女	44	2019年3月15日-2022年3月14日	<p>曾任上海天歌通信技术有限公司项目管理主管，联芯科技有限公司战略与市场部总经理，上海浦东科技投资有限公司投资总监，无锡清石华晟投资有限公司副总经理，合肥东芯通信股份有限公司董事。现任无锡清石华晟投资有限公司董事，上海临芯投资管理有限公司董事、副总经理，新疆浦富股权投资有限公司经理，深圳临芯投资有限公司执行董事兼总经理，浙江临晟投资管理有限公司监事，无锡英迪芯微电子科技股份有限公司监事会主席，上海声瀚信息科技有限公司董事，湖南格兰德芯微电子有限公司董事，思睿博半导体（珠海）有限公司董事，昂赛微电子（上海）有限公司董事，公司董事。</p>	<p>无锡清石华晟投资有限公司董事，上海临芯投资管理有限公司董事、副总经理，新疆浦富股权投资有限公司经理，深圳临芯投资有限公司执行董事兼总经理，浙江临晟投资管理有限公司监事，无锡英迪芯微电子科技股份有限公司监事会主席，上海声瀚信息科技有限公司董事，湖南格兰德芯微电子有限公司董事，思睿博半导体（珠海）有限公司董事，昂赛微电子（上海）有限公司董事</p>	-	-	无
-----	----	---	----	-----------------------	--	--	---	---	---



康捷	独立董事	男	43	2019年3月15日-2022年3月14日	<p>曾任 Arthur Anderson LLP 审计师，法国巴黎百富勤融资有限公司投资银行部经理，贝尔斯登亚洲公司董事、总经理，上海小南国海之源餐饮管理有限公司 CEO，上海蓝英房地产投资有限公司执行董事，上海蓝育房地产投资有限公司执行董事。现任上海歆霖投资管理有限公司执行董事，上海小南国华晶食品科技发展有限公司董事长，小南国控股有限公司董事，Tang Media Partners Limited 董事，Tang Media Partners (China) Limited 董事，Tang Media Pictures Hong Kong Limited 董事，Contech Television Limited 董事，IM Global LLC 董事，Global Road Entertainment LLC 董事，Global Road Entertainment Television LLC 董事，上海歆霖影业有限公司执行董事，上海歆畅企业管理咨询咨询有限公司执行董事，上海歆时投资管理有限公司执行董事，上海灵迅影视传媒有限公司执行董事兼总经理，浙江东阳歆霖文化传媒有限公司经理、执行董事，上海歆光影业有限公司执行董事，北京歆光影业有限公司执行董事、经理，上海灵迅企业发展有限公司执行董事、总经理，公司独立董事。</p>	<p>上海歆霖投资管理有限公司执行董事，上海小南国华晶食品科技发展有限公司董事长，小南国控股有限公司董事，Tang Media Partners Limited 董事，Tang Media Partners (China) Limited 董事，Tang Media Pictures Hong Kong Limited 董事，Contech Television Limited 董事，IM Global LLC 董事，Global Road Entertainment LLC 董事，Global Road Entertainment Television LLC 董事，上海歆霖影业有限公司执行董事，上海歆畅企业管理咨询咨询有限公司执行董事，上海歆时投资管理有限公司执行董事，上海灵迅影视传媒有限公司执行董事兼总经理，浙江东阳歆霖文化传媒有限公司经理、执行董事，上海歆光影业有限公司执行董事，北京歆光影业有限公司执行董事、经理，上海灵迅企业发展有限公司执行董事、总经理</p>	6.00	-	无
----	------	---	----	-----------------------	---	---	------	---	---





黄益建	独立董事	男	40	2019年3月15日-2022年3月14日	曾任中央财经大学讲师，九州证券股份有限公司独立董事，沈阳商业城股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会计财务专业副教授，成都华神科技集团股份有限公司独立董事，聚辰半导体股份有限公司独立董事，久期智博（北京）投资有限公司执行董事，北京石头世纪科技股份有限公司独立董事，中电电机股份有限公司（603988.SH）独立董事，公司独立董事。	中央财经大学会计财务专业副教授，成都华神科技集团股份有限公司独立董事，聚辰半导体股份有限公司独立董事，久期智博（北京）投资有限公司执行董事，北京石头世纪科技股份有限公司独立董事，中电电机股份有限公司（603988.SH）独立董事	6.00	-	无
窦晓波	独立董事	男	40	2019年3月15日-2022年3月14日	现任东南大学电气工程学院电力电子技术系主任、分布式发电与主动配电网研究所副所长、博士生导师，南京磐能电力科技股份有限公司独立董事，南京国铁电气有限公司独立董事，公司独立董事。	东南大学电气工程学院电力电子技术系主任、分布式发电与主动配电网研究所副所长、博士生导师，南京磐能电力科技股份有限公司独立董事，南京国铁电气有限公司独立董事	6.00	-	无
李宗清	监事会主席	男	35	2019年3月15日-2022年3月14日	曾任无锡华润华晶微电子有限公司研发工程师，中芯国际集成电路制造有限公司失效分析工程师，新洁能半导体产品经理。现任公司监事会主席兼技术部项目处长。	未在其他单位兼职	53.14	0.16%	无
吴国强	监事	男	53	2019年3月15日-2022年3月14日	曾任中国电子科技集团公司第五十八研究所刻蚀工艺技术主管，丹东安顺微电子有限公司产品部经理、生产部经理，新洁能半导体销售经理。现任公司监事兼销售部项目处长。	未在其他单位兼职	35.08	0.16%	无
刘松涛	监事	男	41	2019年3月15日-2022年3月14日	曾任上海深远文体设备有限公司财务会计，龙旗科技（上海）有限公司财务经理、投资经理，苏州同冠微电子有限公司监事，上海贝岭投资主管、投资部经理。现任上海岭芯微电子有限公司总经理，深圳市锐能微科技有限公司监事，公司监事。	上海岭芯微电子有限公司总经理，深圳市锐能微科技有限公司监事	-	-	无



纪文勇	监事	男	49	2019年3月15日-2022年3月14日	任无锡第一棉纺织厂财务审计部会计，国联证券有限责任公司下属营业部的财务部会计、财务部经理、总经理助理，国联期货有限责任公司财务部负责人，无锡国联物业有限责任公司财务部负责人，无锡大饭店有限公司财务总监，江苏中科泛物联网科技股份有限公司财务总监，无锡微纳产业发展有限公司董事、副总经理。现任无锡国联产业投资有限公司首席风险官，中丽(天津)产城融合发展基金管理有限公司监事，无锡市总会计师协会副会长，无锡国发云韧创业投资有限公司监事会主席，公司监事。	无锡国联产业投资有限公司首席风险官，中丽(天津)产城融合发展基金管理有限公司监事，无锡市总会计师协会副会长，无锡国发云韧创业投资有限公司监事会主席	-	-	无
陈伟	监事	男	46	2019年3月15日-2022年3月14日	曾任恒信证券有限责任公司投资部经理，泰阳证券有限责任公司投行部高级经理，信泰证券有限责任公司投行部高级经理，齐鲁证券有限责任公司投行部执行总经理，华福证券有限责任公司投行部副总经理、股权业务部总经理。现任上海金浦新朋投资管理有限公司董事、副总经理，理昂生态能源股份有限公司监事，公司监事。	上海金浦新朋投资管理有限公司董事、副总经理，理昂生态能源股份有限公司监事	-	-	无
王永刚	副总经理	男	44	2019年3月15日-2022年3月14日	曾任无锡华润上华半导体有限公司工艺开发经理、质量经理。现任公司副总经理。	未在其他单位兼职	54.49	0.12%	无
陆虹	财务负责人	女	42	2019年3月15日-2022年3月14日	曾任江苏华锦五金机械总公司会计，无锡市大公税务师事务所职员，江苏神剑数码科技有限公司财务经理，新洁能半导体董事、财务经理、财务负责人，电芯联智控监事，电基集成财务负责人。现任公司财务负责人。	未在其他单位兼职	45.63	0.12%	无
肖东戈	董事会秘书	男	30	2019年3月15日-2022年3月14日	曾任河南永华联合会计师事务所(普通合伙)审计员，河南亚圣实业集团有限公司审计专员，广发证券股份有限公司机构业务部项目经理。现任公司董事会秘书。	未在其他单位兼职	45.63	0.20%	无

注1：此处薪酬情况为2019年度税前薪酬。王文荣、宋延延、刘松涛、纪文勇、陈伟均为公司机构投资者委派董事或监事，不在公司领取薪酬。

注2：此处持股比例为直接持股。

## 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

截至目前，公司控股股东、实际控制人朱袁正直接持有公司31.11%股权。同时朱袁正分别与叶鹏、王成宏、戴锁庆、周洞濂、顾朋朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆虹、肖东戈共计10名股东签订有关一致行动的协议，约定上述十位股



东在公司股东大会或董事会表决时，应主动与朱袁正保持一致，因此朱袁正可控制的股权比例为35.62%。除此之外，朱袁正未从事任何与公司相同、相似的业务，与公司之间不存在同业竞争。公司控股股东、实际控制人简要情况如下：

朱袁正，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：22010419640309\*\*\*\*，住所：江苏省无锡市滨湖区蓓蕾新村\*\*。

## 九、财务会计信息和管理层讨论与分析

### （一）简要财务报表

#### 1、简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	80,785.53	61,749.17	46,142.10
流动资产	69,333.29	51,053.91	43,619.52
固定资产	9,373.65	4,628.40	735.48
负债总额	23,623.61	14,408.20	10,939.26
流动负债	22,845.34	14,380.06	10,939.26
股东权益	57,161.92	47,340.97	35,202.84
归属母公司股东的股东权益	57,161.92	47,340.97	35,202.84

#### 2、简要合并利润表

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业总收入	77,253.69	71,579.03	50,375.98
营业利润	11,057.09	16,245.68	6,326.14
利润总额	11,049.44	16,228.76	6,314.66
净利润	9,820.95	14,141.89	5,189.11
归属母公司股东的净利润	9,820.95	14,141.89	5,189.11
扣非后归属母公司股东的净利润	8,762.74	13,955.56	6,867.81

#### 3、简要合并现金流量表



单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	7,512.66	9,437.76	7,217.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,237.29	-8,331.84	-740.37
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,028.76	11,084.77
汇率变动对现金的影响	-2.10	17.57	-32.28
现金及现金等价物净增加额	5,273.28	-905.26	17,529.22

## (二) 非经常性损益

报告期内，本公司非经常性损益情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益	-0.30	-1.15	-0.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,253.88	236.50	495.38
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	10.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7.35	-15.77	-10.81
与公司正常经营业务无关的其他应收款项计提的资产减值损失	-	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目（股份支付）	-	-	-2,099.30
减：所得税影响额	188.01	33.24	74.22
减：少数股东权益影响额	-	-	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,058.21</b>	<b>186.33</b>	<b>-1,678.70</b>

## (三) 主要财务指标

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动比率	3.03	3.55	3.99
速动比率	2.44	2.78	3.50
资产负债率（母公司）	28.23%	21.74%	22.92%
归属于母公司股东的每股净资产（元） <sup>注</sup>	7.53	6.24	4.64
无形资产占净资产比例（扣除土地使用权）	0.33%	0.16%	0.01%

项目	2019年度	2018年度	2017年度
存货周转率（次）	4.81	5.70	7.12
应收账款周转率（次）	9.53	11.43	6.06
息税折旧摊销前利润（万元）	11,811.63	16,412.69	6,438.31
归属于母公司股东的净利润 （万元）	9,820.95	14,141.89	5,189.11
归属于母公司股东扣除非经常性 损益后的净利润（万元）	8,762.74	13,955.56	6,867.81
利息保障倍数	-	-	375.62
每股净现金流量（元） <sup>注</sup>	0.69	-0.12	2.31
每股经营活动产生的现金流量净 额（元） <sup>注</sup>	0.99	1.24	0.95

注：在计算该等指标时，为保证可比计算口径，公司股本数量均采用 7,590 万股。

## （四）管理层讨论与分析

### 1、公司财务状况分析

报告期各期末，公司各类资产金额及占总资产的比例如下：

单位：万元

项 目	2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	29,306.33	36.28%	20,221.72	32.75%	22,902.86	49.64%
应收票据	14,938.24	18.49%	12,130.85	19.65%	8,380.86	18.16%
应收账款	10,052.23	12.44%	5,338.78	8.65%	6,542.53	14.18%
预付款项	40.09	0.05%	66.85	0.11%	123.58	0.27%
其他应收款	188.12	0.23%	1,053.96	1.71%	346.53	0.75%
存货	13,703.00	16.96%	11,124.82	18.02%	5,321.47	11.53%
其他流动资产	1,105.29	1.37%	1,116.93	1.81%	1.70	0.00%
<b>流动资产合计</b>	<b>69,333.29</b>	<b>85.82%</b>	<b>51,053.91</b>	<b>82.68%</b>	<b>43,619.52</b>	<b>94.53%</b>
固定资产	9,373.65	11.60%	4,628.40	7.50%	735.48	1.59%
在建工程	342.22	0.42%	4,473.88	7.25%	468.26	1.01%
无形资产	1,286.70	1.59%	1,199.53	1.94%	1,149.87	2.49%
商誉	3.01	0.00%	3.01	0.00%	3.01	0.01%
长期待摊费用	72.75	0.09%	-	-	-	-
递延所得税资 产	358.48	0.44%	132.73	0.21%	108.30	0.23%

其他非流动资产	15.43	0.02%	257.72	0.42%	57.66	0.12%
<b>非流动资产合计</b>	<b>11,452.24</b>	<b>14.18%</b>	<b>10,695.26</b>	<b>17.32%</b>	<b>2,522.57</b>	<b>5.47%</b>
<b>资产总计</b>	<b>80,785.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,749.17</b>	<b>100%</b>	<b>46,142.10</b>	<b>100%</b>

报告期各期末，公司资产总额分别为 46,142.10 万元、61,749.17 万元和 80,785.53 万元。其中，流动资产占总资产的比例分别为 94.53%、82.68% 和 85.82%，主要由货币资金、应收票据及应收账款、存货等构成；非流动资产占总资产的比例分别为 5.47%、17.32% 和 14.18%，主要由固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产构成。

报告期各期末，公司主要资产构成及变动情况如下图所示：



报告期内公司偿债能力指标如下所示：

指 标	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动比率	3.03	3.55	3.99
速动比率	2.44	2.78	3.50
资产负债率（母公司）	28.23%	21.74%	22.92%
指 标	2019 年度	2018 年度	2017 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	11,811.63	16,412.69	6,438.31
利息保障倍数	-	-	375.62

报告期内，公司存货周转率、应收账款周转率如下：

指 标	2019 年度	2018 年度	2017 年度
存货周转率（次）	4.81	5.70	7.12
应收账款周转率（次）	9.53	11.43	6.06

## 2、公司盈利能力分析

报告期内，公司营业收入明细情况如下：

单位：万元

项 目	2019 度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	77,147.55	99.86%	71,508.23	99.90%	50,329.92	99.91%
其他业务收入	106.14	0.14%	70.80	0.10%	46.06	0.09%
合 计	<b>77,253.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>71,579.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,375.98</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重在 99% 以上，其他业务收入占比极低，公司营业收入、主营业务收入均保持逐年增长。公司其他业务收入主要为向客户提供研究开发服务及出售废料。报告期内，公司提供研究开发服务的收入分别为 39.50 万元、44.19 万元和 28.66 万元，金额很小。

公司产品按照产品形式可分为芯片和功率器件两类，按照产品具体内容可分为沟槽型功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET、超结功率 MOSFET 及其他。报告期内，公司具体产品的收入构成具体情况如下：

单位：万元

项目	具体产品	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
芯片	沟槽型功率 MOSFET	15,991.85	20.73%	18,142.10	25.37%	19,163.23	38.08%
	屏蔽栅功率 MOSFET	649.68	0.84%	517.22	0.72%	277.01	0.55%
	超结功率 MOSFET	3,582.28	4.64%	2,801.14	3.92%	2,026.21	4.03%
	其他	22.84	0.03%	2.45	0.00%	11.86	0.02%
	小计	20,246.66	26.24%	21,462.91	30.01%	21,478.31	42.68%
功率器件	沟槽型功率 MOSFET	30,524.35	39.57%	27,959.68	39.10%	21,188.33	42.10%
	屏蔽栅功率 MOSFET	18,202.75	23.59%	15,657.70	21.90%	5,160.77	10.25%
	超结功率 MOSFET	7,986.65	10.35%	6,395.11	8.94%	2,500.30	4.97%



	其他	187.14	0.24%	32.83	0.05%	2.20	0.00%
	小计	56,900.89	73.76%	50,045.32	69.99%	28,851.61	57.32%
	<b>合计</b>	<b>77,147.55</b>	<b>100%</b>	<b>71,508.23</b>	<b>100%</b>	<b>50,329.92</b>	<b>100%</b>

上述产品中，沟槽型功率 MOSFET 和屏蔽栅功率 MOSFET 主要用于手机周边、平衡车等消费电子领域以及电动车控制器、电动车大功率充电器等电动车领域，超结功率 MOSFET 主要用于 LED 照明、HID 灯等照明领域以及 TV 电源、服务器电源等消费电子领域，其他类型产品主要用于电动工具、工业电机等工业电子领域。

报告期内，公司主营业务收入按地区分布情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内销售	74,205.11	96.19%	70,515.99	98.61%	47,433.89	94.25%
其中：华东地区	34,686.64	44.96%	34,676.73	48.49%	23,418.40	46.53%
华南地区	37,525.99	48.64%	33,919.40	47.43%	22,211.89	44.13%
其他地区	1,992.49	2.58%	1,919.85	2.68%	1,803.59	3.58%
境外销售	2,942.43	3.81%	992.24	1.39%	2,896.03	5.75%
其中：东亚地区	2,819.61	3.65%	891.16	1.25%	2,888.43	5.74%
其他地区	122.82	0.16%	101.08	0.14%	7.59	0.02%
<b>合计</b>	<b>77,147.55</b>	<b>100%</b>	<b>71,508.23</b>	<b>100%</b>	<b>50,329.92</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司以内销为主，外销为辅，且内销及外销收入占比基本稳定。其中，公司内销以华东和华南地区为主，外销以东亚地区为主。

报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	43,648.90	56.58%	41,524.47	58.07%	33,991.45	67.54%
经销	33,498.65	43.42%	29,983.76	41.93%	16,338.47	32.46%
<b>合计</b>	<b>77,147.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>71,508.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,329.92</b>	<b>100.00%</b>

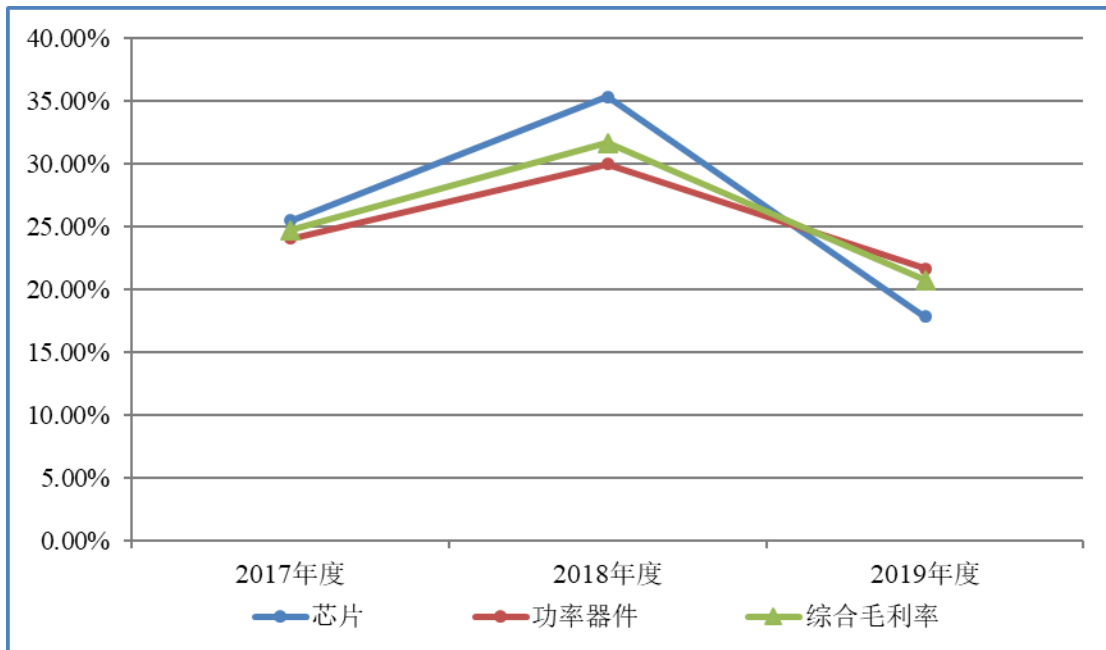
报告期内，公司直销收入占比分别为 67.54%、58.07% 和 56.58%，经销收入占比分别为 32.46%、41.93% 和 43.42%。报告期内，公司以直销为主。



报告期内，公司综合毛利率情况如下表：

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
综合毛利率	20.73%	31.63%	24.69%
主营业务毛利率	20.62%	31.56%	24.62%
其中：芯片	17.82%	35.32%	25.45%
功率器件	21.61%	29.94%	24.00%

报告期内，公司主营业务按主要产品类别划分的毛利率变动情况如下：



2017年至2018年，公司综合毛利率呈平稳上升态势。2017年及2018年，公司综合毛利率增长较大的主要原因为：公司芯片毛利率持续快速上升以及功率器件销售占比和毛利率均有所提升，引致公司综合毛利率增长较大。2019年，公司芯片和功率器件毛利率均有所下降，引致公司综合毛利率有所下滑。

### 3、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动现金流入小计	76,027.85	70,473.08	54,535.72
经营活动现金流出小计	68,515.19	61,035.31	47,318.62
经营活动产生的现金流量净额	<b>7,512.66</b>	<b>9,437.76</b>	<b>7,217.11</b>

投资活动现金流入小计	-	-	1,010.91
投资活动现金流出小计	2,237.29	8,331.84	1,751.28
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,237.29</b>	<b>-8,331.84</b>	<b>-740.37</b>
筹资活动现金流入小计	-	-	12,101.62
筹资活动现金流出小计	-	2,028.76	1,016.86
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-2,028.76</b>	<b>11,084.77</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	<b>-2.10</b>	<b>17.57</b>	<b>-32.28</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,273.28</b>	<b>-905.26</b>	<b>17,529.22</b>

报告期内，公司现金流量主要数据变动情况如下图所示：



#### 4、未来影响公司财务状况和盈利能力的因素分析

##### (1) 国家产业政策的扶持

半导体产业是我国支柱产业之一，半导体分立器件行业是半导体产业的重要组成部分。发展我国半导体分立器件相关产业，提升国内半导体分立器件研发生产能力是我国成为世界半导体制造强国的必由之路。国家有关部门出台了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》等多项政策为半导体分立器件行业的发展提供了政策保障，明确了发展方向。此外，《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等多项政策亦明确了电力电子功率器件的地位和范围，提出了要重点发展MOSFET和IGBT功率器件的要求。国家相关政策的出台有利于半导体分立器件行业市场规模的增长，并进一步促进了半导体分立器件行业健康、

稳定和有序的发展。

## (2) 所得税政策

公司为经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。报告期内，公司所得税税率减按15%执行。根据目前的经营状况及发展趋势，公司具备维系高新技术企业资格的各项条件。

## (3) 研发能力

公司为国内领先的半导体功率器件设计企业之一，2016年至2019年连续四年名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司是江苏省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合认定的高新技术企业，且为中国半导体行业协会会员、中国电源学会理事单位。公司亦为江苏半导体行业协会2017年度先进会员单位，已建立了江苏省功率器件工程技术研究中心、江苏省企业研究生工作站、东南大学-无锡新洁能功率器件技术联合研发中心。公司参与的“智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用”项目已获得2019年度江苏省科学技术一等奖，并获得2020年度国家技术发明奖提名且已经通过初评。自成立以来，公司始终专注于半导体功率器件行业，具备独立的MOSFET和IGBT芯片设计能力和自主的工艺技术平台。公司新产品开发能力强，产品导入市场速度快，已经掌握了屏蔽栅功率MOSFET、超结功率MOSFET、IGBT等特色工艺技术，并形成了具有自主知识产权的核心技术体系。公司是国内率先量产全球先进技术的屏蔽栅功率MOSFET及超结功率MOSFET的公司之一，是国内最早同时拥有沟槽型功率MOSFET、超结功率MOSFET、屏蔽栅功率MOSFET及IGBT四大产品平台的本土企业之一。截至2020年1月19日，公司已拥有97项专利，其中发明专利35项。此外，公司参与在IEEE TDMR等国际知名期刊中发表论文13篇，其中SCI收录论文7篇。公司与科研院所所在功率器件设计领域开展长期合作，针对重点项目成立了技术攻关小组，以全力推进高端功率MOSFET和IGBT芯片及模块的研发与产业化，并且持续布局SiC/GaN宽禁带半导体功率器件的前沿领域，紧跟最先进的技术梯队，提升公司核心产品竞争力。

#### **（4）公司股票发行上市的影响**

本次公开发行募集资金到位后，将进一步增大公司的资产规模，优化产品结构，强化规模效应，降低生产成本；有助于改善公司的法人治理结构和管理水平，提高公司知名度和影响力，进一步提高公司盈利水平，从而全面提升公司的综合竞争实力和抗风险能力。

### **（五）股利分配政策**

#### **1、股利分配一般政策**

公司股票全部为普通股，每股享有同等权益，实行同股同利的分配政策，按各股东持有股份的比例派发股利。

#### **2、报告期股利分配情况**

2015年4月21日，新洁能召开2015年第一次临时股东大会，决议以2014年度末总股本1,000.00万股为基数，每10股派发股票红利7.2股，共计720.00万股。

2018年5月14日，新洁能召开2017年度股东大会，决议以2,530.00万股总股本为基数，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东以每10股转增20股。

2018年9月12日，新洁能召开2018年第一次临时股东大会，决议以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.64元（含税）。

#### **3、发行前滚存利润的安排**

根据公司2018年11月19日通过的2018年第三次临时股东大会决议：为兼顾新老股东利益，在公司首次公开发行股票完成后，由本公司新老股东按持股比例共同享有本次首次公开发行股票前的滚存利润。

#### **4、发行后的股利分配政策**

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》，公司发行上市后，股利分配政策主要内容如下：

##### **“（一）公司利润分配原则**

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持

连续性和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

## （二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

## （三）现金分红条件

公司实施现金分红一般应同时满足以下条件：

1、公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）。

3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的50%且超过5000万元人民币。

## （四）现金分红的比例和间隔：

公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的50%且超过5000万元人民币。

#### （五）发放股票股利的条件

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

#### （六）利润分配的决策机制和程序

1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方可提交董事会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

#### （七）利润分配政策调整的决策机制与程序

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并分别经监事会和二分之一以上独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体董事的二分之一以上同意。”

## （六）公司控股子公司、参股子公司基本情况

截至本招股书签署日，公司拥有新洁能香港、电基集成2家全资子公司以及新洁能深圳分公司、新洁能宁波分公司2家分公司，无参股子公司。具体情况如下：

### 1、新洁能香港

公司名称	新洁能功率半导体（香港）有限公司		成立时间	2010年7月6日	
注册资本	51.00万美元		实收资本	6.10万美元	
注册地址	香港皇后大道中181号新纪元广场（低座）1501室				
经营范围	电力电子元器件的研发、生产、销售；集成电路的研发、销售和贸易				
股东构成	股东名称		股权比例		
	新洁能		100.00%		
	合计		100.00%		
主要财务数据（万元） （已经申报会计师审计）	2019年12月31日			2018年12月31日	
	总资产	61.97		总资产	62.27
	净资产	61.97		净资产	62.27
	2019年度			2018年度	
	净利润	-0.30		净利润	5.52

### 2、电基集成

公司名称	无锡电基集成科技有限公司		成立时间	2017年3月21日	
注册资本	12,000.00万元		实收资本	12,000.00万元	



<b>注册地址</b>	无锡市新吴区研发二路以南、研发一路以东			
<b>经营范围</b>	电子元器件、电力电子元器件及半导体模块产品及其它电子产品的设计、制造、销售；集成电路及其它电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、制造、销售；计算机软件的研发、技术转让；环境保护专用设备的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>		<b>股权比例</b>	
	新洁能		100.00%	
	<b>合计</b>		<b>100.00%</b>	
<b>主要财务数据（万元）</b> （已经申报会计师审计）	<b>2019年12月31日</b>		<b>2018年12月31日</b>	
	总资产	13,157.51	总资产	13,368.84
	净资产	11,762.76	净资产	11,946.87
	<b>2019年度</b>		<b>2018年度</b>	
	净利润	-184.11	净利润	-44.70

### 3、新洁能深圳分公司

<b>公司名称</b>	无锡新洁能股份有限公司深圳分公司	<b>成立时间</b>	2013年12月4日
<b>统一社会信用代码</b>	914403000846106229		
<b>营业场所</b>	深圳市宝安区西乡街道西乡大道与前进二路交汇处美兰商务中心802		
<b>经营范围</b>	电力电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、销售；计算机软件的研发、技术转让；利用自有资产对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。环境保护专用设备的制造、销售。		

### 4、新洁能宁波分公司

<b>公司名称</b>	无锡新洁能股份有限公司宁波分公司	<b>成立时间</b>	2019年10月10日
<b>统一社会信用代码</b>	91330212MA2GU7ACX6		
<b>营业场所</b>	浙江省宁波市鄞州区实怡中心8幢26号10-6		
<b>经营范围</b>	电力电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、销售；计算机软件的研发、技术转让；环境保护专用设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		



## 第四节 募集资金运用

根据2018年11月19日通过的2018年第三次临时股东大会决议，公司拟申请向社会公开发行人民币普通股A股，发行数量为不超过2,530.00万股。募集资金总额将根据市场情况和向询价对象的询价情况确定。根据股东大会的授权，2020年6月2日经公司第三届董事会第八次会议及2020年7月31日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，对本次投资项目的募集资金使用金额进行调整。

本次发行A股募集资金计划全部用于以下与主营业务相关的项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化	48,118.04	20,000.00
2	半导体功率器件封装测试生产线建设	32,014.90	20,000.00
3	碳化硅宽禁带半导体功率器件研发及产业化	11,419.27	-
4	研发中心建设	5,501.86	4,898.80
5	补充流动资金	5,000.00	-
合计		<b>102,054.07</b>	<b>44,898.80</b>

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金，先行投入。本次公开发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于投资项目资金需求量，公司将通过银行贷款和其他自筹资金解决。

### 一、超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化项目

本项目位于无锡新吴区，研发一路以东，研发二路以南地块。项目旨在对公司现有产品升级换代，开发新一代超低能耗高可靠性半导体功率器件，突破超低能耗功率器件设计技术门槛，打破国外产品在高端应用领域的垄断地位。

本项目总投资额为48,118.04万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占比	第一年	第二年	第三年
----	----	-----	----	-----	-----	-----

<b>1</b>	<b>固定资产投资</b>	<b>6,094.60</b>	<b>12.67%</b>	<b>3,689.40</b>	<b>2,405.20</b>	-
1.1	设备投资	5,764.60	11.98%	3,359.40	2,405.20	-
1.2	土建投资	330.00	0.69%	330.00	-	-
<b>2</b>	<b>研发费用</b>	<b>33,782.29</b>	<b>70.21%</b>	<b>7,067.47</b>	<b>11,353.53</b>	<b>15,361.29</b>
2.1	开发费用	1,182.00	2.46%	198.00	442.00	542.00
2.2	试制费用	25,486.30	52.97%	5,394.91	8,548.49	11,542.90
2.3	封装测试费用	6,763.99	14.06%	1,424.56	2,263.03	3,076.39
2.4	IP core	350.00	0.73%	50.00	100.00	200.00
<b>3</b>	<b>软件投资</b>	<b>1,120.00</b>	<b>2.33%</b>	<b>1,120.00</b>		
<b>4</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>7,121.15</b>	<b>14.80%</b>	<b>2,373.72</b>	<b>2,373.72</b>	<b>2,373.72</b>
	<b>合计</b>	<b>48,118.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,250.59</b>	<b>16,132.44</b>	<b>17,735.01</b>

项目建设期为36个月，运营期为T+1期至T+10期。根据规划，项目建成后，运营期T+1期部分开发产品陆续正式投产，T+1期达到设计产能的40%，T+2期产能达到80%，T+3期完全达产。根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：

指标名称	指标值	
年平均销售收入（万元）	83,144.45	
年平均利润总额（万元）	7,491.05	
年平均上缴所得税（万元）	1,123.66	
年平均税后利润（万元）	6,367.39	
年总投资收益率	15.57%	
	所得税前	所得税后
内部收益率	24.15%	21.19%
财务净现值（ic=10%）（万元）	24,729.48	18,920.37
投资回收期（含建设期）	5.74	6.15

## 二、半导体功率器件封装测试生产线建设项目

本项目位于无锡新吴区，研发一路以东，研发二路以南地块。主要建设内容包括：针对公司现有的封装形式（DPAK/SOT/TO）进行产业链延伸；TO-247/TO-3P IGBT及大功率MOSFET芯片封装；低热阻SOP-8封装的产业化；基于Cu-Clip工艺技术，实现高功率密度低功耗器件封装；芯片封装集成器件及大功率模块的研发

和封装产业化。

本项目总投资额为32,014.90万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占比	第一年	第二年
<b>1</b>	<b>固定资产投资</b>	<b>29,319.40</b>	<b>91.58%</b>	<b>20,671.40</b>	<b>8,648.00</b>
1.1	设备投资	25,482.00	79.59%	16,834.00	8,648.00
1.2	土建投资	3,837.40	11.99%	3,837.40	-
<b>2</b>	<b>软件投资</b>	<b>255.00</b>	<b>0.80%</b>	-	<b>255.00</b>
<b>3</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>2,440.50</b>	<b>7.62%</b>	<b>1,220.25</b>	<b>1,220.25</b>
	<b>合 计</b>	<b>32,014.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,891.65</b>	<b>10,123.25</b>

项目建设期为18个月，运营期为T+1期至T+10期。运营期T+1期公司开始正式投产，产能利用率为40%，T+2期为80%，T+3到T+10期100%完全达产。根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：

指标名称	指标值	
年平均销售收入（万元）	28,494.62	
年平均利润总额（万元）	5,107.24	
年平均上缴所得税（万元）	1,276.81	
年平均税后利润（万元）	3,830.42	
年总投资收益率	15.95%	
	所得税前	所得税后
内部收益率	16.52%	12.45%
财务净现值（ic=10%）（万元）	10,670.81	3,893.75
投资回收期（含建设期）	6.61	7.61

### 三、碳化硅宽禁带半导体功率器件研发及产业化项目

本项目位于无锡新吴区，研发一路以东，研发二路以南地块。本项目是基于宽禁带半导体碳化硅材料的功率器件研发及产业化，包括SiC SBD（肖特基二极管）及SiC MOSFET两类产品。本项目的实施旨在突破高压SiC功率器件关键技术，重点针对碳化硅二极管浪涌电流能力提升技术、碳化硅二极管雪崩耐量提升技术、沟槽底部氧化层峰值电场抑制技术、器件终端边缘电场疏导技术进行研发。开发

碳化硅功率器件，打破国外产品在碳化硅宽禁带半导体功率器件技术垄断，实现我国碳化硅功率器件的国产化。

本项目总投资额为11,419.27万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占比	第一年	第二年	第三年
<b>1</b>	<b>固定资产投资</b>	<b>767.75</b>	<b>6.72%</b>	<b>426.65</b>	<b>341.10</b>	-
1.1	设备投资	497.75	4.36%	156.65	341.10	-
1.2	土建投资	270.00	2.36%	270.00	-	-
<b>2</b>	<b>研发费用</b>	<b>9,561.85</b>	<b>83.73%</b>	<b>1,667.62</b>	<b>2,850.19</b>	<b>5,044.04</b>
2.1	开发费用	848.00	7.43%	224.00	312.00	312.00
2.2	试制费用	8,158.19	71.44%	1,345.55	2,374.71	4,437.93
2.3	封装测试费用	355.67	3.11%	58.07	103.48	194.11
2.4	IP core	200.00	1.75%	40.00	60.00	100.00
<b>3</b>	<b>软件投资</b>	<b>280.00</b>	<b>2.45%</b>	<b>280.00</b>	-	-
<b>4</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>809.67</b>	<b>7.09%</b>	<b>269.89</b>	<b>269.89</b>	<b>269.89</b>
<b>合计</b>		<b>11,419.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,644.16</b>	<b>3,461.18</b>	<b>5,313.93</b>

项目建设期为36个月，即为T+1期至T+3期。根据规划，项目建设期公司将完成SiC SBD及SiC MOSFET系列产品的研发。同时，T+1期部分开发产品陆续正式投产，T+1期达到设计产能的40%，T+2期产能达到80%，T+3期完全达产。根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：

指标名称	指标值	
年平均销售收入（万元）	9,541.13	
年平均利润总额（万元）	855.04	
年平均上缴所得税（万元）	128.26	
年平均税后利润（万元）	726.78	
年总投资收益率	7.49%	
	所得税前	所得税后
内部收益率	16.64%	14.74%
财务净现值（ic=10%）（万元）	1,901.29	1,304.56
投资回收期（含建设期）	7.06	7.36

## 四、研发中心建设项目

本项目位于无锡新吴区，研发一路以东，研发二路以南地块。项目旨在完善和加强公司在半导体功率器件领域的综合技术研发能力与项目产业化能力，依托公司研发中心，充分调动产业链核心技术资源，创新开发功率器件领域的新技术、新产品，打破国际大厂在高端功率器件上的长期垄断地位。研发中心计划开展的主要研发项目有：高效高可靠性电机驱动系统中功率器件的研发与产业化、低能耗大功率MOSFET模块的研发及功率器件综合实验室的升级。

项目总投资为5,501.86万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占比	第一年
<b>1</b>	<b>固定资产投资</b>	<b>5,335.86</b>	<b>96.98%</b>	<b>5,335.86</b>
1.1	设备投资	4,870.86	88.53%	4,870.86
1.2	土建投资	465.00	8.45%	465.00
<b>2</b>	<b>软件投资</b>	<b>166.00</b>	<b>3.02%</b>	<b>166.00</b>
	<b>合计</b>	<b>5,501.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,501.86</b>

本项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但研发中心的建设将提升公司整体研发实力、提高核心竞争力，研发实力的提升可增强客户对公司的信任度，进一步强化公司的品牌优势，扩大市场份额，实现公司长远的战略目标。

## 五、补充流动资金项目

报告期内，公司发展迅速，经营规模呈现快速增长趋势。2016年至2018年，公司分别实现营业收入42,211.51万元、50,375.98万元和71,579.03万元，年复合增长率达到30.22%。在国家半导体产业政策大力支持以及下游市场需求持续增长的背景下，预计未来公司经营规模仍将保持快速增长的趋势。公司资产主要以流动资产为主，公司日常经营较多涉及现款支付，折旧、摊销类的非现金支出相对较少。因此，公司需要保持较高水平的流动资金用于新产品技术研发、人才引进、原材料采购、市场销售等环节，以保持公司的竞争优势和行业领先地位，推动公司业务可持续发展。

通过补充流动资金，公司可进一步优化财务结构，防范经营风险，保证公司



业务的顺利开展，有利于公司扩大业务规模，提高公司的综合竞争力，为公司未来可持续发展创造宽松的资金环境和良好的融资条件。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

#### (一) 市场风险

##### 1、市场波动风险

半导体分立器件作为基础性电子元器件,为国民经济的多个领域所必不可少,因此半导体分立器件行业的下游分布极为广泛。广泛的下游应用领域提升了公司应对单一市场波动风险的能力,但半导体分立器件行业与宏观经济的整体发展的景气程度密切相关,国内经济整体增速放缓及中美贸易摩擦等因素通过对下游行业的生产经营产生不利影响进而传导至半导体分立器件行业。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷,半导体分立器件行业的市场需求也将随之受到影响;下游行业的波动和低迷会导致对半导体分立器件的需求下降、价格敏感性提高。虽然近几年全球半导体分立器件市场保持稳步增长,且亚洲地区特别是中国市场规模增幅巨大,但是如果由于中美贸易摩擦等因素引致下游市场整体持续波动、全球经济或国内经济发生重大不利变化,将对半导体分立器件行业及公司等行业内企业的经营业绩造成不利影响。

##### 2、行业竞争风险

近年来随着我国消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的蓬勃发展以及新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等新兴领域凸起,国内对半导体分立器件的需求迅速扩大,直接拉动了行业的快速发展,也吸引了国内外企业进入到行业内,市场竞争日趋激烈。一方面,国内半导体分立器件企业不断增加,且部分企业不断通过技术升级等措施提高竞争力;另一方面,国外优秀的半导体分立器件企业进入国内抢占市场份额。在日趋激烈的市场竞争环境下,如果公司不能持续进行技术升级、提高产品性能、降低产品成本以及优化营销网络,则很可能在未来的市场竞争中丧失优势,从而对公司持续盈利造成不利影响。

##### 3、产品替代风险

半导体分立器件行业属于技术密集型行业,具有技术和产品更新换代速度较

快的特点。半导体分立器件下游应用领域日新月异，产品的形态、功能以及差异化需求在短时间内都可能发生很大变化，这都导致半导体分立器件产品生命周期越来越短，替代现象日趋显现。未来，随着新材料的应用和新技术的不断突破，在满足经济性条件下，新一代的半导体分立器件产品将可能出现，并对现有的产品形成一定冲击。如果公司不能持续紧跟行业发展前沿并进行技术升级换代、研发适应行业和市场的产品，则公司存在产品被替代的风险，从而失去持续经营能力。

#### 4、采购价格波动风险

芯片代工和封测服务为公司主要的采购内容，占产品成本的比重较大。芯片代工和封测服务价格的波动将对公司的经营业绩产生一定影响。芯片代工价格一方面受到硅晶圆材料价格和制造成本、人工成本影响，另一方面则受到芯片代工企业投资规模和产能影响；封测服务价格受到原材料价格和人工成本等影响。报告期内，公司与国内主要的芯片代工企业和封装测试企业建立了较为紧密的合作关系，对其采购价格在一定区间内合理波动，且公司亦能够通过适度调整产品结构 and 价格、产品技术升级等方式进行应对。但是，如果芯片代工和封测服务的市场价格持续大幅上涨、而公司无法采取有力措施进行应对，则将对公司盈利能力造成不利影响。

### （二）运营风险

#### 1、供应商依赖的风险

公司是半导体专业化垂直分工企业，芯片代工及封装测试环节主要通过向供应商采购。公司拥有涵盖了华虹宏力、华润上华、中芯集成等国内少数几家具备 MOSFET、IGBT 等 8 英寸半导体芯片代工能力的本土芯片代工供应商，并不断拓展韩国等地区的芯片代工供应渠道。而在封装测试环节，公司主要与长电科技（600584）、安靠技术（Amkor）、通富微电（002156）等全球领先的封装测试企业合作，一定程度上也保证了公司产品的领先性。由于半导体行业垂直分工的特殊性，专注于芯片设计环节的企业在选择供应商后一般不会轻易更换；同样，芯片代工及封装测试企业如若更换客户则需重新调整产线、设备技术参数、产能排期等，这将形成较大的更换成本。因此，双方在一定程度上相互依赖。如果公司



主要供应商产能严重紧张或者双方关系恶化，则可能导致公司产品无法及时、足量供应，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

## 2、供应链管理不善风险

半导体分立器件行业高度分工协作，产业链包括芯片设计、芯片制造、封装测试、对外销售等环节，各个环节相互依存、高度相关。行业内企业根据分工不同采用垂直一体化或垂直分工模式，其中部分垂直分工模式的企业主要负责芯片设计研发和销售环节，而将芯片制造、封装测试环节主要委托给专业代工厂商完成，因此，其产品质量、交货时间、生产能力等都与产业链其他环节紧密相关。公司为专业化垂直分工企业，与行业内优秀的芯片制造和封装测试厂商建立了长期、稳定的合作关系。公司建成封装测试产线，实现少部分功率器件的自主生产，公司不断加强生产环节的质量、成本管控，保障产品的品质。但是，如果公司对供应链及生产环节管理不善，导致产品质量、交付及时性等出现问题，则会影响公司产品销售和品牌声誉，对公司的经营造成不利影响。

## 3、新产品开发风险

公司销售的产品按照是否封装可以分为芯片和功率器件，按照功能分类已形成沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）以及功率模块等多品类产品系列，且 MOSFET 等产品系列较为全面。公司在现有产品的基础上，仍紧跟半导体分立器件行业发展前沿，以国际一流企业的最新技术和产品为标杆，以下游市场需求为导向，不断进行新产品的开发。但是，半导体功率器件新产品的研发往往需要一定的时间周期，需要投入较多的人力成本和资金成本，且面临较大的失败风险，或者开发的新产品尚不具备商业价值，可能导致前期的各项成本投入无法收回，从而影响公司经营业绩。

## 4、产品质量控制风险

半导体分立器件属于基础性电子元器件，为下游产品的核心部件之一。半导体分立器件的下游产品对性能要求严格，电子元器件质量出现问题将对下游客户的销售和品牌产生不利影响。因此，半导体分立器件下游行业对器件的质量非常重视，往往在采购前和合作过程中均需反复验证和测试。公司始终将产品质量控

制作为持续发展的重要基础之一，建立了较为健全的质量控制体系，并在各个环节严格把控，产品质量整体保持稳定。但是，半导体分立器件技术和工艺复杂，在不同环节很可能由于多种因素导致产品质量不佳或性能下降，从而导致质量纠纷，影响公司的市场地位和品牌影响力。

## 5、经营模式风险

公司主要采用 Fabless 经营模式，专注于 MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售环节，芯片主要由公司设计方案后交由芯片代工企业进行生产，功率器件主要由公司委托外部封装测试企业对芯片进行封测代工而成，尽管公司已初步完成先进封装测试生产线的建设，将少部分芯片自主封装后对外销售。由于公司本身不具备芯片制造能力以及封装测试生产线规模相对较小，芯片制造、封装测试环节仍需依托芯片代工企业和外部封装测试企业。为保证公司产品供应环节的稳定性，公司已与多家具有雄厚实力的芯片代工企业和封装测试企业建立了长期稳定的合作关系。但在半导体分立器件行业生产旺季，可能会存在芯片代工企业和封装测试企业产能不足，不能完全保证公司产品及时供应的风险。

## （三）技术风险

### 1、技术升级的风险

半导体分立器件行业为技术密集型行业，行业竞争的关键在于新技术、新产品的竞争。新技术、新产品的研发及产业化应用周期长、投入大，且新产品量产产，还面临着产品更新换代速度快、产品不能满足市场需求变化的风险。公司拥有高素质的技术研发团队，并与科研院所所在半导体功率器件设计领域开展长期合作。公司还成立了技术研发小组专门从事新技术和新产品的研发，并依据行业技术发展趋势、市场动态以及客户需求确定公司的研发规划和具体措施。但是，如果公司的新技术、新工艺的研发未能持续升级换代，新产品的产业化未能保持市场领先地位，将会对公司的市场竞争和经营产生不利的影响。

### 2、技术人才流失风险

研发设计能力是半导体分立器件企业竞争力的核心之一，其主要来源于企业的研发技术人才，因此半导体分立器件产业的快速发展对专业技术人才产生了巨

大的需求。公司在产品技术升级、新产品推出、产品的售后服务等方面高度依赖于公司的研发团队。自成立以来，公司已培养和引进了一批高素质研发人才，并通过实施股权激励、签订保密协议等多项激励和约束机制，以维系研发团队稳定。但是，如果公司核心研发人员大量流失，公司的研发能力、新产品开发及持续盈利能力将受到一定的影响，并可能给公司带来新的竞争对手。

## （四）财务风险

### 1、毛利率下降的风险

2017年至2019年，公司综合毛利率分别为24.69%、31.63%和20.73%。2017年至2018年，受益于下游市场需求的持续增长，积极拓展毛利率较高的下游应用行业，大力开发新产品和新技术，积极开拓龙头客户从而提升公司品牌影响力和市场美誉度，公司综合毛利率保持稳定上升的趋势。2019年，受中美贸易摩擦及国内市场竞争有所加剧等因素影响，公司芯片和功率器件毛利率有所下降。半导体分立器件企业的经营业绩受产品技术水平、市场竞争情况、下游市场需求等因素影响较大，如果未来公司产品技术优势减弱、市场竞争加剧、市场供求形势出现重大不利变化、采购成本持续提高或者出现产品销售价格持续下降等情况，将导致公司综合毛利率下降。

### 2、应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为6,903.92万元、5,620.98万元和10,588.73万元，占营业收入的比例分别为13.70%、7.85%和13.71%。虽然报告期各期末公司应收账款账龄结构良好，一年以内账龄的应收账款占比超过99%，与同行业可比上市公司相比，公司应收账款占营业收入比例较低、应收账款周转率较高，发生坏账损失的风险较小，且公司已制订合理的坏账计提政策并有效执行，但若公司下游客户经营不利或由于其他原因导致无法按期支付货款，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的风险。

### 3、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货净额分别为5,321.47万元、11,124.82万元和13,703.00万元，占总资产的比例分别为11.53%、18.02%和16.96%。随着公司业务规模的

扩大，存货余额也会进一步上升。公司产品技术更新换代速度较快，如果未来出现由于公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，将增加计提存货跌价准备的风险，对公司经营业绩及经营现金流产生不利影响。

#### 4、所得税优惠政策变动的风险

公司于2017年11月17日通过了高新技术企业复审，取得了《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732001619）。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，报告期内企业所得税实际执行税率为15%。虽然国家税收优惠政策具备持续性，但未来如果上述税收优惠政策发生变化，或者本公司不再具备享受相应税收优惠的资质，则将对公司的经营业绩带来较大的不利影响。

### （五）募集资金投资项目风险

#### 1、募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金投资项目主要包括“超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化”、“半导体功率器件封装测试生产线建设”、“碳化硅宽禁带半导体功率器件研发及产业化”和“研发中心建设”等。本次募集资金投资项目以国家产业政策为基础，充分把握半导体分立器件行业发展趋势而确定。上述募投项目的实施，有利于公司把握行业发展趋势，进一步巩固公司现有业务和培育新的业绩增长点，有效提升公司的技术研发实力和市场竞争力。但是，本次募投项目的实施，公司仍然面临来自市场变化、技术替代、宏观经济波动、募投项目管理等多方面的挑战和不确定性，因此公司存在无法如期完成募投项目或者项目投资收益不达预期的风险。

#### 2、新增折旧摊销费用影响业绩的风险

公司的固定资产和无形资产整体规模较小。本次募投项目计划新增设备投入和生产场地投入，未来将引致公司资产总额增长幅度较高。随着新增固定资产和无形资产规模的扩大，募投项目投产后，资产折旧摊销会出现较快增长。尽管公

司募投项目新增销售收入及利润总额较高，足以抵消募投项目新增的投资项目折旧摊销费用，但如果市场环境发生重大不利变化，公司现有业务及募投项目产生的收入及利润水平未实现既定目标，本次募投项目将存在因资产增加而引致的折旧摊销费用影响未来经营业绩的风险。

## （六）其他风险

### 1、关联交易风险

报告期内，公司存在向关联方采购封测服务或销售产品的情形。针对上述关联交易，第一，公司制定了《关联交易决策制度》，对公司关联交易定价机制、审批决策程序等予以规范，并要求公司严格执行；第二，公司积极扩大采购渠道，加大销售力度，逐步减少与关联方之间的采购与销售占比；第三，公司控股股东、实际控制人、主要股东及公司董事、监事、高级管理人员签署减少和规范关联交易的相关承诺。虽然公司与关联方之间的关联购销主要系受到行业特点、技术要求、产品质量控制等因素影响而采取的自发市场行为，交易具有其合理性、公允性，交易占比逐年下降，但如果未来公司关联购销定价不公允，可能对公司和股东的经济利益产生不利影响。

### 2、成长性风险

公司的主营业务为 MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售。随着半导体功率器件下游需求的迅猛增长以及公司产品技术实力不断提升，公司经营规模迅速扩大。报告期内，公司营业收入分别为 50,375.98 万元、71,579.03 万元和 77,253.69 万元，2018 年和 2019 年分别同比增长 42.09% 和 7.93%。近年来国内半导体分立器件行业不断发展，国际巨头不断涌入，国内新进入者不断增多，行业竞争日趋激烈。未来公司能否保持持续、快速的增长，仍然受制于产业政策支持、宏观经济发展、下游行业增长、公司技术实力提升以及经营管理完善等多方面因素，因此，公司未来的经营业绩可能面临成长性风险。

### 3、摊薄即期回报风险

报告期内，公司扣除非经常性损益后的每股收益分别为 0.98、1.84 和 1.15，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 26.04%、33.28% 和 16.77%。本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，通过本次募集

资金提升公司研发实力、资金实力，其综合经济效益的产生需要一定的时间，投资项目回报的实现需要一定周期。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于总股本和净资产的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

## 二、其他重要事项

截至2019年12月31日，公司正在履行的重大商务合同如下：

### （一）重要合同

#### 1、重大销售合同

报告期内，公司与部分长期合作、采购量大、采购频繁的客户签订销售框架合同，日常销售以订单为交易依据。截至2019年12月31日，公司正在履行的对生产经营活动有重大影响的主要销售框架合同如下：

序号	合同相对方	合同编号	合同期限	合同标的
1	常州力森电子有限公司	NCEGXHT229	2018.01.01- 2019.12.31	产品型号、数量等均以订单为准
2	星恒电源股份有限公司	NCEGXHT224	2018.01.01- 2019.12.31	产品型号、数量等均以订单为准
3	苏州工业园区东南科技有限公司	NCEGXHT170-1	2019.12.23- 长期	产品型号、数量等均以订单为准
4	无锡市晶汇电子有限公司	NCEGXHT254	2018.12.30- 2020.12.29	产品型号、数量等均以订单为准
5	上海晶丰明源半导体股份有限公司	NCEGXHT122	2017.09.19- 2020.09.18	产品型号、数量等均以订单为准
6	深圳市高斯宝电气技术有限公司	HR-PU-HP10-08A2	2017.07.31- 长期	产品型号、数量等均以订单为准
7	广东科通电子实业有限公司	NCEGXHT195	2018.01.01- 2019.12.31	产品型号、数量等均以订单为准
8	南京江智科技有限公司	NCEGXHT236	2018.01.01- 2019.12.31	产品型号、数量等均以订单为准
9	杰华特微电子(杭州)有限公司	NCEGXHT121	2019.08.01- 长期	产品型号、数量等均以订单为准
10	昆山九通电子有限公司	NCEGXHT251	2018.12.30- 2020.12.29	产品型号、数量等均以订单为准
11	揭阳市中晶电子科技有限公司	NCEGXHT233	2018.01.01- 2019.12.31	产品型号、数量等均以订单为准

12	无锡川本飞龙电子科技有限公司	080201	2016.08.02-2026.08.01	产品型号、数量等均以订单为准
13	常州市易尔通电子有限公司	NCEGXHT253	2018.12.30-2020.12.29	产品型号、数量等均以订单为准
14	昂宝电子（上海）有限公司	NCEGXHT208	2018.01.01-2019.12.31	产品型号、数量等均以订单为准
15	深圳市润得源电子有限公司	NCEGXHT110-1	2019.06.10-长期	产品型号、数量等均以订单为准
16	深圳市粤嘉鸿电子有限公司	NCEGXHT150	2019.07.20-长期	产品型号、数量等均以订单为准
17	东莞市盛锋电子有限公司	NCEGXHT162	2017.08.25-2020.08.24	产品型号、数量等均以订单为准
18	深圳市嘉龙腾电子有限公司	NCEGXHT211	2018.07.16-2020.07.15	产品型号、数量等均以订单为准
19	安徽省东科半导体有限公司	NCEGXHT212-1	2019.11.10-长期	产品型号、数量等均以订单为准
20	南京高上美电子有限公司	NCEGXHT277	2019.05.07-2021.05.06	产品型号、数量等均以订单为准
21	广州视琨电子科技有限公司	114-SK	2018.09.01-长期	产品型号、数量等均以订单为准
22	深圳市金誉半导体股份有限公司	NCEGXHT112-2	2018.07.01-2020.06.30	产品型号、数量等均以订单为准

## 2、重大采购合同

公司采购合同的订立方式主要是通过签订框架协议，日常采购以订单作为交易依据。截至 2019 年 12 月 31 日，公司正在履行的对生产经营活动有重大影响的主要采购框架合同如下：

序号	合同相对方	合同编号	合同期限	合同标的
1	华虹宏力	【2018】0602	2018.06.05-2021.06.04	芯片代工
2	华润上华	WXXJN-CSMC-18120901	2018.12.09-2021.12.08	芯片代工
3	华润微	rev.20170724	2017.08.17-长期	芯片代工
4	长电科技	S03001-01	2019.03.02-2021.03.01	封测服务
5	江阴苏阳电子股份有限公司	S03002-03	2019.06.17-2022.06.16	封测服务
6	上海捷敏	SH-2017-111	2018.01.01-2021.12.31	封测服务
7	成都集佳科技	S03016-01	2017.01.01-	封测服务



	有限公司		2020.12.31	
8	中芯集成电路 制造(绍兴)有 限公司	20180305-01	2018.03.05- 2021.03.04	芯片代工

## (二) 公司对外担保情况

截至招股说明书签署日，公司无对外担保情况。

## (三) 重大诉讼及仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，公司主要股东、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。





## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

### 一、本次发行各方当事人的情况

名称	住所	联系电话	传真	联系人
发行人：无锡新洁能股份有限公司	无锡市高浪东路999号B1号楼2层	0510-85618058	0510-85620175	肖东戈
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	0755-22626653	0755-25325422	盛金龙
发行人律师：江苏世纪同仁律师事务所	南京市中山东路532-2号D幢5楼	025-83304480	025-83329335	阚赢 张若愚
申报会计师：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼	025-84711188	025-84716883	游世秋 杨贤武
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦	021-58708888	021-58899400	-
收款银行：平安银行总行营业部	-	-	-	-
拟上市的证券交易所：上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868	-

### 二、本次发行上市的重要日期

初步询价日期	2020年9月10日
发行公告刊登日期	2020年9月15日
网上网下申购、缴款日期	2020年9月16日、2020年9月18日
股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市



## 第七节 备查文件

投资者可以在下列地点查阅整套发行申请材料和有关备查文件。

(一) 发行人：无锡新洁能股份有限公司

联系地址：无锡市新吴区新加坡工业园新达路延伸段（道路东侧）

联系人：肖东戈

联系电话：0510-85618058

传真：0510-85620175

(二) 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

联系人：盛金龙

联系电话：0755-22626653

传真：0755-25325422



(本页无正文,为《无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》之盖章页)



2020年9月15日